การเปลี่ยนโครงสร้างของซิลเวอร์แกลเลียมไคเทลลูไรค์และซิลเวอร์อินเคียมไคเทลลูไรค์ภายใต้ความคันสูง

นายคมศิลป์ โคตมูล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย STRUCTURAL PHASE TRANSITIONS OF AgGaTe_2 AND AgInTe_2 UNDER HIGH PRESSURE

Mr. Komsilp Kotmool

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Physics Department of Physics Faculty of Science Chulalongkorn University Academic year 2008 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเปลี่ยนโครงสร้างของซิลเวอร์แกลเลียมไดเทลลูไรด์และซิลเวอร์			
	อินเดียมไดเทลลูไรด์ภายใต้ความดันสูง			
โดย	นาย คมศิลป์ โคตมูล			
สาขาวิชา	ฟิสิกส์			
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์			

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หาญหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัจฉา ฉัตราภรณ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์)

คมศิลป์ โคตมูล : การเปลี่ยนโครงสร้างของซิลเวอร์แกลเลียมไดเทลลูไรด์และซิลเวอร์ อินเดียมไดเทลลูไรด์ภายใต้ความดันสูง. (STRUCTURAL PHASE TRANSITIONS OF AgGaTe₂ AND AgInTe₂ UNDER HIGH PRESSURE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์, 55 หน้า.

การเปลี่ยนโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำซิลเวอร์แกลเลียมไดเทลลูไรด์ (AgGaTe₂) และซิล เวอร์อินเดียมไดเทลลูไรด์ (AgInTe₂) ภายใต้ความดันสูงถึง 10 GPa และ 26 GPa ตามลำดับ ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมโดยทำการทดลองโดย The Daresbury Synchrotron Radiation Source, สหราชอาณาจักร ด้วยความยาวคลื่น 0.46540 และ 0.44397 Å ได้ใช้ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์แบบเมอร์ริลล์-แบสเสทท์ เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดัน การวัดความ ดันด้วยเทคนิคการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ในทับทิม และใช้อิมเมจเพลตเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกแถบ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งในสาร AgInTe₂ ได้ทำการ คำนวณด้วยทฤษฎีเชิงฟังก์ชันของความหนาแน่น เพื่อเปรียบเทียบและสนับสนุนผลการทดลอง

และกระบทฤษฎายากนารผยยงกร แพทะ แผน งายะบรยยะกรยนและผมปลุมพลากรทางสงง
 ผลการทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าโครงสร้างที่ความดันสูงของ
 ทั้งสาร AgGaTe₂ และ AgInTe₂ เป็นโครงสร้างที่มีการจัดเรียงตัวของไอออนบวกเป็นแบบสุ่ม และ
 ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างและค่าคงที่แลตทิชที่วัดได้ในกระบวนการลดความดันมีความ
 แตกต่างจากค่าที่วัดได้ในกระบวนการเพิ่มความดัน สำหรับสาร AgGaTe₂ พบว่าการเปลี่ยน
 โครงสร้างครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนจากโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ไปเป็นโครงสร้างแบบเททระโกนัลที่มี
 หมู่สมมาตร P 4 ที่ความดันประมาณ 4.02 GPa ซึ่งมีโครงสร้างร่วมที่ความดันสูงที่มียอดเกิดขึ้น
 ค่อนข้างน้อย จึงทำให้ไม่สามารถระบุโครงสร้างเบบซิงค์เบลนด์เป็นโครงสร้างอุปเสถียร ในการ
 เปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 3 - 4 GPa และ 21.70 GPa
 ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่ง ทั้งนี้พบว่าทั้งผลการทดลองและผลการคำนวณ
 ด้วย DFT โครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิกที่มีหมู่สมมาตร
 เป็น *Cmcm* สำหรับการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สอง พบว่าไม่มีการเปลี่ยนหมู่สมมาตร แต่มีการ
 เป็น 2002) ในทิศทาง [010]

ภาควิชา : <u>ฟิสิกส์</u>	ลายมือชื่อนิสิต <u>:</u>
สาขาวิชา : <u>ฟิสิกส์</u>	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :
ปีการศึกษา <u>: 2551</u>	

4972238923 : MAJOR PHYSICS

KEY WORD : X-RAY DIFFRACTION / CHALCOPYRITE / HIGH PRESSURE / AgGaTe₂ / AgInTe₂ KOMSILP KOTMOOL : STRUCTURAL PHASE TRANSITIONS OF AgGaTe₂ AND AgInTe₂ UNDER HIGH PRESSURE. THESIS PRINCIPAL ADVISOR : ASST. PROF. THITI BOVORNRATANARAKS, Ph.D., 55 pp.

Structural phase transformation of AgGaTe₂ and AgInTe₂ were studied under high pressure up to 10 GPa and 26 GPa, respectively. The experiments were carried out using angle dispersive X-ray diffraction with synchrotron radiation source by The Daresbury Synchrotron Radiation Source, UK with wavelengths of 0.46540 Å and 0.44397 Å. MB diamond anvil cell was used in this high pressure apparatus with pressure transmitting medium. Ruby fluorescence techniques were used for pressure determination. Two dimensional diffraction patterns were recorded on an image plate. In addition, the DFT calculations have been performed to investigate a first structural phase transition in AgInTe₂ in order to compare with our experimental data.

The high pressure phase of $AgGaTe_2$ and $AgInTe_2$ were confirmed to be cation disordered structures. Transition pressure and lattice constant obtained from the increasing pressure and the reverse processes are difference. For $AgGaTe_2$, the first structural phase transition occurs around 4.03 GPa which exhibits a chalcopyrite to $P\overline{4}$ structural transition. The coexisting phases were identified by a few accompanying peaks. For $AgInTe_2$, the metastable structure, zinc blend, appears at the ambient pressure with the chalcopyrite phase. The first phase transition occurs around 3 - 4 GPa, from ambient phases to *Cmcm* phase. The second phase transition in $AgInTe_2$ occurs around 21.70 GPa in which the space group remain the same, but the (002) plane was translationally moved in [010] direction.

Department : <u>Physics</u>	Student's Signature :
Field of Study : Physics	Principal Advisor's Signature :
Academic Year : 2008	

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการสนับสนุนและความช่วย เหลือจากทุกท่าน ทุกภาคส่วน ดังนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ สำหรับแนวคิดของหัวข้อวิทยานิพนธ์ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างที่หาค่าเปรียบ มิได้ ความเอาใจใส่เอื้ออาทร และทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เปิดโลกทัศน์และโอกาสให้ผู้จัดทำ วิทยานิพนธ์ได้พบเห็น

ขอขอบพระคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนทุนการ ศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ (สหวิทยาการด้านพลวัตรทางวิชาการ) ที่สนับสนุนทุนในวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำที่เป็น ประ โยชน์ยิ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ประสิทธิประสาทวิชาการ แนวคิด ที่ส่งผลกับการพัฒนาตนเอง และการทำวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างยิ่ง

ที่ขาดมิได้ขอกราบขอบพระคุณพ่ออินทร์และแม่มุยที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับทุกสิ่ง ทุกอย่างของชีวิตจนสุดที่จะบรรยาย พี่สาวและพี่ชาย ที่ให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกัน คุณบุญ ลดา สุวรรณหารกับกำลังใจที่ดีที่สุด

สารบัญ

หน้า
บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญช
สารบัญตารางณ
สารบัญภาพญ บทที่
1. บทน้ำ1
5.1 ความเป็นมาและความสำคัญ1
5.2 วัตถุประสงค์การทำวิจัย2
5.3 ขอบเขตการวิจัย2
5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ2
5.5 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์2
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง4
2.1 โครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรท์ของสารกึ่งตัวนำ AgGaTe ₂ และ AgInTe ₂ 4
2.2 อุณหพลศาสตร์ของโครงสร้างผลึกภายใต้ความดันสูง
2.3 เทคนิคการทดลองเพื่อหาโครงสร้างผลึก7
2.3.1 เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม7
2.3.2 อิมเมจเพลต8
2.3.3 ขั้นตอนการหาโครงสร้างผลึกของสาร
2.3.4 วิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์
2.4 ทฤษฎีเชิงฟังก์ชันของความหนาแน่น (DFT)
3. เทคนิคการทดลองและการคำนวณ20
3.1 เทคนิคการศึกษาโครงสร้างที่ความดันสูง
3.1.1 ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ (DAC)
3.1.2 การวัดความดัน23
3.2 หลักการและขั้นตอนการคำนวณด้วย DFT

บทที่	หน้า
4. ผลการวิเคราะห์และผลการคำนวณ	26
4.1 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe ₂	26
4.1.1 โครงสร้างของสาร AgInTe ₂ ที่ความดันบรรยากาศ	26
4.1.1.1 ผลการทดลองจากเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	
ชนิดกระจายมุม	26
4.1.1.2 ผลการคำนวณด้วย DFT	28
4.1.2 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งของสาร AgInTe ₂	30
4.1.2.1 ผลการทดลองจากเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	
ชนิดกระจายมุม3	30
4.1.2.2 ผลการคำนวณด้วย DFT3	34
4.1.3 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองของสาร AgInTe ₂ 3	39
4.1.4 การเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการลดความดัน4	11
4.2 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe ₂ 4	43
4.2.1 โครงสร้างของสาร AgGaTe ₂ ที่ความดันบรรยากาศ	43
4.2.2 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งของสาร AgGaTe ₂	43
4.2.3 การเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการลดความดัน	48
 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 	49
5.1 สารกึ่งตัวนำ AgInTe ₂	49
5.2 สารกึ่งตัวนำ AgGaTe ₂	51
รายการอ้างอิง	53
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	55

ๆ

สารบัญตาราง

ติาราง	หน้า
4.1 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe ₂ ที่มีโครสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์	28
4.2 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe ₂ ที่มีโครสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรท์	34
4.3 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe ₂ ที่มีโครสร้างผลึกแบบคล้าย NaCl	35
4.4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งจากผลการคำนวณด้วย DFT	
และผลการทดลอง	38
5.1 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งโดยการคำนวณด้วย DFT	50

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแบบซึ่งค์เบลนด์และโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์	4
2.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรวมและปริมาตร	6
2.3 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผงผลึกที่มีการจัดเรียงแบบสุ่ม	8
2.4 การบันทึกข้อมูลลงบนอิมเมจเพลตสองมิติ	9
2.5 การประมวณผลข้อมูลจากอิมเมจเพลต ด้วยโปแกรม EDIPUS	.10
2.6 ผลเชิงกราฟฟิคจากการคำนวณด้วยโปรแกรม GSAS	14
2.7 ขั้นตอนการแก้สมการของโคห์น-ชามด้วยเทคนิคการวนซ้ำและพิจารณาคำตอบด้วย	
วิธีสนามต้องกันในตัว	.18
2.8 ฟังก์ชันคลื่นเทียมและศักย์เทียม	.19
3.1 การจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม	
ที่ The Daresbury Synchrotron Radiation Source	.20
3.2 แผนภาพแสดงส่วนประกอบหลักของไดมอนด์ แอนวิล เซลล์	21
3.3 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ แบบเมอร์ริลล์-แบสเสทท์	.22
3.4 โพรไฟล์ของยอดความยาวคลื่น R ₁ และ R ₂ ที่เกิดจากการฟลูออเรสเซนซ์ในผลึก	
ของทับทิม	.23
3.5 แผนภาพเทคนิคการวัดความดันโดยใช้เลเซอร์กระตุ้นผลึกทับทิม	.24
4.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มกับมุมของแบร็กก์ของสารกึ่งตัวน้ำ AgInTe ₂	
ที่ความดันบรรยากาศ	.26
4.2 กราฟการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ของสารกึ่งตัวนำ	
AgInTe ₂ ที่ความดันบรรยากาศ	.27
4.3 กราฟผลการทดสอบการลู่เข้าของพลังงานในสารกึ่งตัวน้ำ AgInTe ₂	.29
4.4 โพรไฟล์ของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgInTe ₂ ในกระบวนการเพิ่ม	
ความดันจากความดันบรรยากาศถึงความดัน 6.25 GPa	.30
4.5 โพรไฟล์ของการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ ด้วยโครงสร้	้าง
แบบคล้าย NaCl และโครงสร้างแบบ <i>Cmcm</i>	.32
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของสาร AgInTe ₂	.33
4.7 กราฟพลังงานรวมและปริมาตรของโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์และโครงสร้าง	
แบบเททระโกนัล ที่มีหมู่สมมาตรเป็น P4/ <i>mmm</i>	.35

ល្ង

	ป
ภาพประกอบ	หน้า
4.8 โครงสร้างแบบ <i>Cmcm</i> ที่มีมิติ เป็น 2x2x2 และมีตำแหน่งอะตอมเหมือนกับ	
โครงสร้างแบบคล้าย NaCl	37
4.9 กราฟพลังงานรวมและปริมาตรของโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์และโครงสร้าง	
แบบซุปเปอร์เซลล์ของ <i>Cmcm</i>	37
4.10 โพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgInTe₂ในกระบวนการ	
เพิ่มความดันจากความดัน 18.65 GPa ถึงความดัน 25.97 GPa	39
4.11 โพรไฟล์ของการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ ของสาร	
AgInTe ₂ ที่ความดัน 21.70 GPa ด้วยโครงสร้างแบบ <i>Cmcm</i> และโครงสร้างแบบ CsCl	
ของทั้งสเตน	40
4.12 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองของสาร AgInTe ₂ โดยมีการเลื่อนระนาบ (002) ไป	
ในทิศทาง [010] โดยหมู่สมมาตรยังคงเป็น <i>Cmcm</i>	41
4.13 โพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมในกระบวนการลดความดัน	
จากความดัน 10.25 GPa ถึงความดันบรรยากาศ	41
4.14 การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ ของสารกึ่งตัวนำ AgG	aTe ₂
ที่ความดันบรรยากาศด้วยโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์	43
4.15 โพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgGaTe ₂	
ด้วยรังสีเอกซ์ความยาวคลื่น 0.46540 Å และความยาวคลื่น 0.44397 Å	.44
4.16 โพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgGaTe ₂	
ที่ความดัน 5.09 GPa	45
4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของสาร AgGaTe ₂	47
4.18 โพรไฟล์ของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของ AgGaTe ₂ ในกระบวนการการ	
ลดความดันจากความดัน 9.34 GPa ถึงความดันบรรยากาศ	.48
5.1 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe ₂ ในกระบวนการเพิ่มความดัน	
และในกระบวนการลดความดัน	.51
5.2 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe ₂ ในกระบวนการเพิ่มความดัน	
และในกระบวนการลดความดัน	.52

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

โครงสร้างของวัสดุในธรรมชาติมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิและความดันเป็นตัวแปรหลักทางอุณหพลศาสตร์ที่กำหนดโครงสร้างของวัสดุ ทั้งนี้พบว่า ความดันเป็นตัวแปรที่สามารถทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนโครงสร้างที่หลากหลายกว่าอุณหภูมิ ดังนั้น ความดันจึงเป็นตัวแปรที่นักวิจัยให้ความสนใจศึกษากันอย่างแพร่หลาย โครงสร้างที่แตกต่างกัน ของวัสดุส่งผลให้วัสดุมีสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาวัสดุ ภายใต้ความดัน นอกจากจะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแนวทางในการ ออกแบบวัสดุใหม่ที่มีสมบัติเหมาะสำหรับการใช้งานตามต้องการได้ [1] ทั้งนี้ความดันเป็นตัวแปร ทางอุณหพลศาสตร์ ที่ไม่รบกวนระบบของสารและสะดวกในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนโครงสร้าง ของสาร โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มความดันไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ (diamond anvil cell, DAC)

สารกึ่งตัวนำชนิดสารประกอบสาม (ternary compound) มีโครงสร้างผลึกแบบ ชาลโคไพไรท์ (chalcopyrite) ที่ความดันบรรยากาศมีหมู่สมมาตรเป็น I42d ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ความยาวในแกน c มีค่าประมาณสองเท่าของความยาวแกน a ทั้งนี้วัสดุดังกล่าวมีสมบัติทางแสง ที่เหมาะกับการใช้ประยุกต์ในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (optoelectronic devices) [2,3] การศึกษาสารกึ่งตัวนำชาลโคไฟไรท์ภายใต้ความดันสูง พบว่าโครงสร้างที่ความดันสูงมีแนวโน้ม เปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นโครงสร้างแบบคล้าย NaCl (cubic, NaCl-like structure) หรือโครงสร้าง แบบรอมบอฮีดรอล (rhombohedral, α -NaFeO₂) [4]

สารกึ่งตัวนำซิลเวอร์แกลเลียมไดเทลลูไรด์ (AgGaTe₂) และซิลเวอร์อินเดียมได เทลลูไรด์ (AgInTe₂) เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแบบซาลโคไพไรท์ ที่ความดันบรรยากาศ มี ช่องว่างพลังงานเท่ากับ 1.36 eV และ 1.04 eV ตามลำดับ [5] จึงทำให้สารทั้งสองมีศักยภาพใน การพัฒนาเป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษา AgGaTe₂ ภายใต้ความดันสูง จากความ ดันบรรยากาศถึงความดันประมาณ 30 GPa พบว่าเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นโครงสร้างแบบ เททระโกนัล (tetragonal) ที่มีหมู่สมมาตร P4 ที่ความดัน 3.1 GPa และเปลี่ยนโครงสร้างเป็น โครงสร้างผลึกแบบคล้าย NaCl ที่ความดัน 8.6 GPa ทั้งนี้ยังมีโครงสร้างร่วมบางโครงสร้างที่ยัง ไม่สามารถบ่งบอกโครงสร้างได้แน่ซัด [6] สำหรับสาร AgInTe₂ พบว่าที่ความดัน 2.5 GPa และ อุณหภูมิ 250 °C เปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นโครงสร้างแบบคล้าย NaCl [7]

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ และ AgInTe₂ ภายใต้ความดันสูง ทั้งในกระบวนการเพิ่มความดันและกระบวนการลด ความดัน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารภายใต้ความดันสูงในวิทยานิพนธ์นี้ มี ขอบเขตการศึกษา ดังนี้

 1.3.1 ศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ด้วยข้อมูลจากการทดลองที่ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมโดยศึกษาในกระบวนการเพิ่มความดันและในกระบวนการลดความ ดันกลับสู่ความดันบรรยากาศ รวมทั้งทำการคำนวณด้วยทฤษฎีเชิงฟังก์ชันของความหนาแน่น (Density Functional Theory, DFT) ในการเปลี่ยนโครงสร้างภายใต้ความดันสูง

1.3.2 ศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ ด้วยข้อมูลจากการทดลองที่ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมโดยศึกษาในกระบวนการเพิ่มความดันและในกระบวนการลดความ ดันกลับสู่ความดันบรรยากาศ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ฐานข้อมูลตัวแปรสถานะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างในสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ และ AgInTe₂ ดังนี้

1.4.1 โครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิซ และตำแหน่งอะตอมของสารที่ความดันบรรยากาศ

1.4.2 โครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิซ และตำแหน่งอะตอมของสารที่ความดันสูง

1.4.3 ค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร (Bulk modulus) ของโครงสร้างที่ความดันบรรยากาศและที่ ความดันสูง

1.4.4 ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้าง และการลดลงของปริมาตรในการเปลี่ยน โครงสร้าง

1.5 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 บทหลัก ดังนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ บทที่ 2 กล่าวถึง ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ และ AgInTe₂ ภายใต้ความดันสูง ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม โดยนำข้อมูลจากการ ทดลองของ The Daresbury Synchrotron Radiation Source สหราชอาณาจักร มาวิเคราะห์ และทำการคำนวณด้วย DFT บทที่ 3 กล่าวถึงเทคนิคการทดลองและการคำนวณ บทที่ 4 กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์และผลการคำนวณ และบทที่ 5 กล่าวถึงสรุปและอภิปรายผลการวิจัย

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรท์ของสารกึ่งตัวนำ AgGaTe $_2$ และ AgInTe $_2$

สารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ และ AgInTe₂ เป็นสารที่มีโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ มี หมู่สมมาตรเป็น I42d สารที่มีโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ ได้แก่ สารประกอบสาม (ternary compound) ที่ประกอบด้วยธาตุหมู่ I-III-VI₂ และ II-IV-V₂ สำหรับสารต้นแบบ (prototype) ของ โครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ คือ CuFeS₂ ซึ่งเป็นแร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

สำหรับโครงสร้างของสาร AgGaTe₂ และ AgInTe₂ อยู่ในกลุ่มของ I-III-VI₂ ซึ่ง โครงสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ในกลุ่ม II-VI จำนวน 2 เซลล์ โดยแทนที่ ตำแหน่งอะตอมของธาตุหมู่ II ด้วยธาตุหมู่ I และธาตุหมู่ III ในอัตราส่วน 1 : 1 การเปรียบเทียบ โครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์และโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ ดังแสดงในภาพด้านล่าง



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ (ซ้าย) และโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ (ขวา) ซึ่งสามารถ พิจารณาได้ว่าโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ เกิดจากการแทนตำแหน่งของธาตุหมู่ II ในโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์จำนวน 2 เซลล์ ด้วยอะตอมของธาตุหมู่ I และ III ใน สัดส่วน 1:1 ตามตำแหน่งดังภาพ

เนื่องจากความแรงของพันธะระหว่าง I-VI และ III-VI มีความแตกต่างกันจึงทำให้ เกิดการบิดเบี้ยว (distortion) ขึ้นในโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การผิดรูปใน เททระโกนัล (tetragonal distortion, η) โดยที่ $\eta = c/a$ และการกระจัดของไอออนลบ (anion displacement, u) โดยแสดงดังนี้

$$u = \frac{1}{4} + \frac{R_{I-VI}^2 - R_{III-VI}^2}{a^2}$$
(2.1)
เมื่อ R_{I-VI} คือ ความยาวของพันธะระหว่างธาตุหมู่ I และธาตุหมู่ VI

R_{Ⅲ-VI} คือ ความยาวของพันธะระหว่างธาตุหมู่ III และธาตุหมู่ VI

จากสมการที่ 2.1 พบว่าเมื่อ $R_{I-VI} = R_{III-VI}$ จะทำให้ค่า u = 0.25 ซึ่งรูปทรง ทางเรขาคณิตดังกล่าว จะส่งผลให้ $\eta = 2$ ด้วย ดังนั้นปริมาณทั้งสองจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงตำแหน่ง อะตอมหรือเป็นพารามิเตอร์ภายในของโครงสร้างได้ ทั้งนี้ในงานวิจัยที่ผ่านมา จากการศึกษาด้วย เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าโครงสร้างที่ความดันบรรยากาศของสาร AgGaTe₂ มี ค่าคงที่แลตทิซ a = 6.275 Å และ c = 11.906 Å มีพารามิเตอร์ภายในเป็น u = 0.260 และ $\eta = 1.897$ [6] และสำหรับสาร AgInTe₂ มีค่าคงที่แลตทิซเป็น a = 6.406 Å และ c = 12.560 Å มีค่าพารามิเตอร์ภายใน u = 0.25 และ $\eta = 1.96$ [7]

2.2 อุณหพลศาสตร์ของโครงสร้างผลึกภายใต้ความดันสูง

การศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารภายใต้ความดันสูง ตัวแปรสถานะทาง อุณหพลศาสตร์ที่สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนโครงสร้างก็คือ พลังงานเสรีกิบส์ (Gibbs free energy, *G*) ซึ่งแสดงดังนี้ [8]

$$G = E - TS + PV \tag{2.2}$$

จากสมการที่ 2.2 พบว่าพลังงานเสรีกิบส์ ขึ้นอยู่กับพลังงานรวม (*E*) ผลคูณของ เอนโทรปีกับอุณหภูมิ และผลคูณของความดันกับปริมาตร ทั้งนี้การเปลี่ยนโครงสร้างลำดับที่หนึ่ง (first order phase transition) สำหรับกระบวนการอุณหภูมิคงที่ (isothermal process) จะเกิดขึ้น ได้ต้องมีเงื่อนไข คือ $\Delta G = 0$ และ $(\partial G / \partial P)_T = V$ โดยที่ปริมาตรจะต้องมีค่าไม่ต่อเนื่องกัน ระหว่างสองโครงสร้างที่พิจารณา ทั้งนี้เมื่อเราพิจารณาที่ T $\rightarrow 0$ K พบว่าพลังงานเสรีกิบส์จะมีค่า เท่ากับเอนทัลปี (*H*) [9] ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถพิจารณาการเปลี่ยนโครงสร้างได้จากกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรวมและปริมาตร ดังแสดงในภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรวมและปริมาตร ซึ่งเส้นตรงที่สัมผัสกราฟของ โครงสร้าง A และ โครงสร้าง B สามารถบ่งบอกความดันที่เกิดการเปลี่ยนจาก โครงสร้าง A ไปเป็นโครงสร้าง B ในเบื้องต้น

ในกระบวนการอุณหภูมิคงที่ พบว่า $-(\partial E/\partial V)_T = P$ ซึ่งสัมพันธ์กับความชั้น ของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรวมกับปริมาตรนั่นเอง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนโครงสร้าง อย่างเด่นซัดดังแสดงในภาพที่ 2.2 พบว่า $-\Delta E/\Delta V = P_A = P_B$ สรุปได้ว่าความดันดังกล่าวเป็น ความดันที่เริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างเกิดขึ้น ทั้งนี้จุดสัมผัสในกราฟของโครงสร้าง A และกราฟของ โครงสร้าง B มีค่าเอนทัลปีเท่ากัน

ด้วยเหตุนี้เองพลังงานรวมจึงเป็นปริมาณที่มีความสำคัญในการบ่งบอกสภาวะ ของระบบและมีความเชื่อมโยงกับตัวแปรสถานะอื่นด้วย ในการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างภายใต้ ความดันสูงโดยอุณหภูมิคงที่นั้น สมการสถานะที่นิยมใช้เพื่อปรับข้อมูลที่ได้จากการคำนวณและ การทดลอง คือ สมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน (Birch-Murnaghan equation of state) [10] ซึ่งแสดงดังสมการ

$$E(V) = E_0 + \frac{9V_0B_0}{16} \left\{ \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} - 1 \right]^3 B'_0 + \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} - 1 \right]^2 \left[6 - 4 \left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} \right] \right\}$$
(2.3)

ดังนั้น จาก $-\left(\partial E \,/\,\partial V
ight)_T = P$ จะทำให้ได้สมการสถานะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างความดันและปริมาตร แสดงดังนี้

$$P(V) = \frac{3B_0}{2} \left[\left(\frac{V_0}{V} \right)^{7/3} - \left(\frac{V_0}{V} \right)^{5/3} \right] \left\{ 1 + \frac{3}{4} \left(B'_0 - 4 \right) \left[\left(\frac{V_0}{V} \right)^{2/3} - 1 \right] \right\}$$
(2.4)

โดยที่ **B**₀ คือ ค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร ที่ความดันเป็นศูนย์

B' คือ อนุพันธ์ของมอดูลัสเชิงปริมาตรเทียบกับปริมาตร ที่ความดันเป็นศูนย์

 $V_{_0}$ คือ ปริมาตรที่ความดันเป็นศูนย์

อาจกล่าวได้ว่า สมการที่ 2.3 และ 2.4 เป็นสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สาม แต่ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร และปริมาตรที่ ความดันเป็นศูนย์ ระหว่างผลการทดลองกับผลการคำนวณ จึงพิจารณาเลือกใช้สมการสถานะ ของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สอง ในการปรับกับข้อมูล ซึ่งมีค่า $B'_0 = 4$ เพื่อเป็นการจำกัดตัว แปร ทั้งนี้พบว่าผลของการปรับด้วยสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สอง ไม่มีความ แตกต่างไปจากการปรับด้วยสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สามมากนัก

2.3 เทคนิคการทดลองเพื่อหาโครงสร้างผลึก

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม โดยเทคนิคภายใต้ความดันสูงได้ใช้ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ ในการเพิ่ม ความดัน และเทคนิคการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ในทับทิม (Ruby fluorescence) เพื่อวัดความดัน ซึ่ง จะกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ได้ใช้เป็นอิมเมจ เพลตสองมิติที่สามารถปรับระยะห่างจากไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ ได้ จึงทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถหา โครงสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้สำหรับการปรับตัวแปรโครงสร้างโดยละเอียดได้ใช้วิธีการปรับตัว แปรโครงสร้างของริทเวลด์ (Rietveld refinement method) เข้ามาช่วย โดยที่รายละเอียดทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการหาโครงสร้างผลึกจะกล่าวถึงโดยแยกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

2.3.1 เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม

วิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการหา โครงสร้างของวัสดุ โดยใช้รังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นค่าเดียว (monochromatic X-ray) สำหรับ เงื่อนไขการเลี้ยวเบนเป็นไปตามกฎของแบร็กก์ (Braggs' law) [11] ดังแสดงในสมการ

$$2d\sin\theta = n\lambda\tag{2.5}$$

8

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างระนาบ (d-space)

heta คือ มุมของแบร็กก์ (Bragg angles)

λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

ทั้งนี้ในงานวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารภายใต้ความดันสูง จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มความดัน คือ ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับ การเคลื่อนที่ในระหว่างการศึกษา ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 3 ดังนั้นการศึกษาในลักษณะนี้จึง นิยมใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างผงผลึก (powder crystalline sample) เมื่อบรรจุในไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ จะมีการจัดเรียงของผลึกแบบสุ่ม ทำให้ทุกระนาบของอะตอมมีโอกาสที่จะวางตัวในทิศทางที่ ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนขึ้นได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผงผลึกที่มีการจัดเรียงแบบสุ่ม ระนาบที่จัดวางในลักษณะ ที่สอดคล้องกับกฎของแบร็กก์จะเกิดการเลี้ยวเบนขึ้น (ซ้าย) ลักษณะของการเลี้ยวเบน ที่เกิดขึ้นในสารตัวอย่างที่เป็นผงผลึกมีลักษณะเป็นวงกลมในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทาง ของรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบกับตัวอย่างผงผลึก (ขวา)

2.3.2 อิมเมจเพลต

อิมเมจเพลต (Image Plate) เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกแถบการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็นสองมิติ ทำให้ คุณภาพของข้อมูลที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์โครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการใช้ งานอย่างแพร่หลายในเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม

อิมเมจเพลตประกอบด้วยสารเรืองแสงกลุ่ม BaFX:Eu⁺² (X=Cl, Br) เมื่อรังสีเอกซ์ ตกกระทบอิมเมจเพลต พลังงานของโฟตอนจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในสารเรืองแสงข้ามจากแถบ เวเลนซ์ (valence band) ขึ้นมาสู่แถบต้องห้าม (forbidden band) โดยอิเล็กตรอนจะถูกกักไว้ใน คัลเลอร์เซนเตอร์ (color center) ซึ่งเป็นผลมาจากตำหนิแลตทิซ (lattice defect) และจะถูก ประมวลผลโดยเครื่องสแกน ที่มีเลเซอร์เป็นตัวกระตุ้นให้อิเล็กตรอนจากแถบต้องห้ามหลุดกลับไป อยู่แถบเวเลนซ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวอิเล็กตรอนจะปลดปลอยพลังงานแสงที่มีความยาวคลื่น ประมาณ 400 nm ออกมา ความเข้มแสงในแต่ละตำแหน่งจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มของรังสี เอกซ์ที่กระตุ้นในช่วงแรก [12] โดยลักษณะภาพที่ได้จากการใช้อิมเมจเพลตกับเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมดังแสดงในภาพที่ 2.4 และการประมวลผลข้อมูลจาก อิมเมจเพลตให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ของความเข้มและมุมของแบร็กก์ได้แสดงในภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.4 การบันทึกข้อมูลลงบนอิมเมจเพลตสองมิติ ที่ได้จากการทดลองด้วยเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม ซึ่งแถบของการเลี้ยวเบนจะมีลักษณะเป็น วงกลม เนื่องจากการเรียงตัวแบบสุ่มของผงผลึก



ภาพที่ 2.5 การประมวลผลข้อมูลจากอิมเมจเพลตโดยโปรแกรม EDIPUS จะได้ผลออกมาในรูป ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มและมุมของแบร็กก์

2.3.3 ขั้นตอนการหาโครงสร้างผลึกของสาร

จากหัวข้อที่ 2.3.1 และหัวข้อ 2.3.2 ที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม และการใช้อิมเมจเพลตเป็นอุปกรณ์บันทึกแถบการเลี้ยวเบน พบว่า ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคดังกล่าว คือ ความเข้มของรังสีเอกซ์และมุมของแบร็กก์ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาระบุความเป็นไปได้ของโครงสร้างว่าเป็นโครงสร้างแบบใด

สำหรับมุมของแบร็กก์เมื่อพิจารณาจากกฎของแบรกก์แล้ว สามารถหาค่า ระยะห่างระหว่างระนาบที่เกิดการเลี้ยวเบนได้ตามดัชนีมิลเลอร์ (Miller indices) จากรูปทรงทาง เรขาคณิตของระบบแลตทิซของบราเว (Bravais lattice) เช่น ในโครงสร้างแบบที่สามารถเขียนใน ระบบพิกัดฉาก ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างระนาบกับค่าคงที่ แลตทิซเป็นดังนี้ [13]

$$\frac{1}{\left(d_{hkl}\right)^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(2.6)

สำหรับโครงสร้างแบบลูกบาศก์ที่ a=b=c ทำให้สมการที่ 2.6 เป็นดังนี้

$$d_{hkl} = \frac{a}{\left(h^2 + k^2 + l^2\right)^{1/2}}$$
(2.7)

สำหรับโครงสร้างแบบอื่นก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างระนาบกับ ค่าคงที่แลตทิซเป็นไปตามรูปทรงทางเรขาคณิตของโครงสร้างนั้น ๆ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแล้ว การใช้ โปรแกรมเพื่อระบุโครงสร้างทำให้การระบุโครงสร้างมีความสะดวกและง่ายขึ้น ในงานวิจัยนี้เองได้ ใช้โปรแกรม DICVOL04 ในการระบุโครงสร้างในเบื้องต้น [14] ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวพัฒนาโดย โบลูทิฟและเลาเออร์ (A.Bolutif and D.Louer) จากมหาวิทยาลัยแห่งเรนเนส (University of Rennes) ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับความเข้มของรังสีเอกซ์จากการทดลองนั้น เป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก ชนิดและตำแหน่งของอะตอม โดยจากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม (I_{hkl}) กับแฟคเตอร์ โครงสร้าง (Structure factor, F_{hkl}) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเป็น $I_{hkl} \propto \left|F_{hkl}\right|^2$ โดยที่แฟคเตอร์ โครงสร้างเขียนได้ในรูป

$$F_{hkl} = \sum_{j} f_{j} \exp 2\pi i (hx_{j} + ky_{j} + lz_{j})$$

$$f_{j} \qquad \qquad \vec{h}$$
อ แฟคเตอร์การกระเจิงของอะตอม j (atomic scattering

factor) ซึ่งขึ้นอยู่กับเลขอะตอม

เมื่อ

 x_i, y_i, z_i คือ ตำแหน่งของอะตอม j ในพิกัด (x, y, z)

การที่จะรู้ว่าโครงสร้างที่สมบูรณ์ของสารเป็นอย่างไรนั้น จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งที่ แน่นอนของอะตอม ซึ่งปริมาณที่บ่งบอกตำแหน่งของอะตอมได้ก็คือ ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (electron density, ρ(x, y, z)) ทั้งนี้สามารถหาความหนาแน่นอิเล็กตรอนได้ดังสมการ

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{V} \sum_{h_{\min}}^{h_{\max}} \sum_{k_{\min}}^{k_{\max}} \sum_{l_{\min}}^{l_{\max}} \left| F_{hkl} \right| \cos[2\pi(hx + ky + lz) - \alpha_{hkl}]$$
(2.9)
เมื่อ α_{hkl} คือ มุมเฟสของระนาบ (hkl)

จากสมการที่ 2.9 พบว่าปริมาณที่ไม่ทราบค่าก็คือ มุมเฟส แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติสามารถแก้ค่าหามุมเฟสได้ด้วยการสุ่มทางสถิติ โดยการอ้างอิงกับผลการทดลองเป็น หลัก

2.3.4 วิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์

จากหัวข้อที่ 2.3.3 แม้ว่าจะได้สมการความหนาแน่นอิเล็กตรอนแล้วก็ตาม เมื่อ เปรียบเทียบผลการทดลองกับผลที่ได้จากการคำนวณอาจมีผลที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากสาร ตัวอย่าง อุปกรณ์การทดลอง และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะทำการทดลอง ซึ่งปริมาณ ต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในแฟคเตอร์ค่าตรวจแก้ (correction factor) ดังนั้นต้องทำการปรับค่า ปริมาณดังกล่าวรวมทั้งตำแหน่งอะตอมเพื่อให้ได้ผลที่สอดคล้องกับผลการทดลอง วิธีการปรับค่า แปรโครงสร้างของริทเวลด์ เป็นวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยริท เวลด์(H.M.Rietveld) ในปี ค.ศ. 1969 [15] โดยหลักการของวิธีการนี้ ก็คือการจำลองโครงสร้างที่ เป็นไปได้ ซึ่งหาได้จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น โดยนำโครงสร้าง ที่จำลองขึ้นมาทำการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่เป็น ความสัมพันธ์ของความเข้มกับมุมของแบร็กก์ ด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุด (least-square method) โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือจากค่า χ^2 ดังนี้

$$\chi^{2} = \sum_{i} w_{i} (Y_{oi} - Y_{ci})^{2}$$
(2.10)

โดยที่ Y_{..} คือ ความเข้มจากการทดลอง ที่มุมของแบร็กก์ ลำดับที่ i

Y_{ci} คือ ความเข้มจากการคำนวณ ที่มุมของแบร็กก์ ลำดับที่ i

W_i คือ ค่าน้ำหนักทางสถิติ ลำดับที่ i โดยมีค่าเป็น 1/Y_{oi}

จากสมการที่ 2.10 พบว่าโครงสร้างที่จำลองขึ้นจะมีความสอดคล้องกับผลการ ทดลองเท่าใดนั้นสามารถพิจารณาได้จากค่า χ^2 ซึ่งยิ่งปริมาณดังกล่าวมีค่าน้อย ก็สามารถกล่าว ได้ว่าโครงสร้างที่จำลองขึ้นจะมีความสอดคล้องกับผลการทดลองมากเท่านั้น โดยที่การปรับตัว แปรโครงสร้างดังกล่าวเป็นการปรับให้ความเข้มจากการคำนวณเข้าใกล้ค่าความเข้มจากการ ทดลองแบบลำดับต่อลำดับ ซึ่งความเข้มที่ได้จากการคำนวณมีความสัมพันธ์กับแฟคเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้

$$Y_{ci} = s \sum_{K} L_{K} \left| F_{K} \right|^{2} \varphi \left(2\theta_{i} - 2\theta_{K} \right) P_{K} A + Y_{bi}$$

$$(2.11)$$

- โดยที่ *s* คือ แฟคเตอร์สเกล
 - K คือ ดัชนีมิลเลอร์ ที่ (hkl) ใด ๆ
 - arphiคือ ฟังก์ชันของโพรไฟล์การสะท้อนที่ระนาบ K ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ $2 heta_i 2 heta_K$
 - *F_K* คือ แฟคเตอร์โครงสร้าง
 - L_K คือ แฟคเตอร์ของโลเร็นตซ์ (Lorentz function)
 - P_K คือ ฟังก์ชันความโน้มเอียงในการจัดเรียง (preferred orientation function)
 - A คือ แฟคเตอร์การดูดกลื่น
 - Y_{bi} คือ ความเข้มพื้นหลัง ลำดับที่ *i*

แฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่แสดงในข้างต้น เป็นปริมาณที่ต้องมีการปรับค่า เพื่อให้ผลจาก การคำนวณสอดคล้องกับผลการทดลอง ซึ่งปริมาณที่เป็นตัวบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าผลการปรับตัว แปรโครงสร้างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั้น คือ แฟคเตอร์อะกรีเมนท์ (agreement factor) ซึ่ง พิจารณาจาก 2 ปริมาณ ได้แก่ แฟคเตอร์ของโพรไฟล์ (profile factor, R_p) และแฟคเตอร์ของโพร ไฟล์แบบถ่วงน้ำหนัก (weighted profile factor, R_{wp}) โดยปกติแล้วค่า $R_{wp} > R_p$ โดยแฟคเตอร์ ทั้งสองแสดงดังสมการต่อไปนี้

$$R_{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |Y_{oi} - Y_{ci}|}{\sum_{i=1}^{n} Y_{oi}} \times 100\%$$
(2.12)

$$R_{wp} = \left[\frac{\sum_{i}^{n} w_{i} |Y_{oi} - Y_{ci}|^{2}}{\sum_{i}^{n} w_{i} Y_{oi}}\right]^{\frac{1}{2}} \times 100\%$$
(2.13)

เนื่องจากลำดับของความเข้มที่แบ่งตามมุมของแบร็กก์ที่ใช้พิจารณา มีจำนวน ค่อนข้างมาก ซึ่งในทางปฏิบัติได้แบ่งออกเป็นขั้นละ 0.02° ดังนั้น วิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของ ริทเวลด์จึงเหมาะต่อการคำนวณด้วยโปรแกรมช่วยคำนวณ ในงานวิจัยนี้เองได้ใช้โปรแกรม GSAS (Generalized Structure Analysis System) [16] ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยลาร์สันและวอน ดรีลี (Larson and Von Dreele) จากห้องปฏิบัติการลอส อลามอส (Los Alamos Laboratory) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถประมวลผลการปรับตัวแปรโครงสร้างออกมาทั้งเชิง กราฟิกและเชิงปริมาณ จึงทำให้สะดวกต่อผู้ใช้โปรแกรม การประมวลผลในเชิงกราฟิกในโปรแกรม GSAS สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพิจารณาการปรับตัวแปรโครงสร้าง ซึ่งแถบของความ แตกต่างจากการทดลองและจากการคำนวณ เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวแปร โครงสร้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งถ้าแถบดังกล่าวมีลักษณะเรียบ สามารถบ่งบอกได้ว่าโครงสร้างที่คำนวณมี ความสอดคล้องกับผลจากการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 ผลเชิงกราฟิกจากการคำนวณด้วยโปรแกรม GSAS

2.4 ทฤษฎีเชิงฟังก์ชันของความหนาแน่น (DFT)

การศึกษาโครงสร้างของสารภายใต้ความดันสูงในงานวิจัยนี้ ได้ทำการ ศึกษาจาก การคำนวณด้วย DFT ซึ่งเป็นการคำนวณเชิงจำลองอีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาระบบหลาย อนุภาค (many-body system) โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory) ทั้งนี้จะ ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ทฤษฎีและเทคนิคการคำนวณด้วย DFT พอสังเขป [17-19]

ในการศึกษาเชิงโครงสร้างของระบบหลายอนุภาค พลังงานรวมของระบบถือว่า เป็นปริมาณที่สำคัญที่จะบ่งบอกถึงเสถียรภาพของโครงสร้างได้ นอกจากนี้พลังงานรวมของระบบ ยังมีความสัมพันธ์กับตัวแปรสถานะอื่น ๆ ที่สามารถอธิบายถึงสภาวะของโครงสร้าง ซึ่งได้กล่าวไว้ แล้วในหัวข้อ 2.2 ทั้งนี้จากความรู้ในปัจจุบันการคำนวณหาพลังงานรวมของระบบในระดับอะตอม จำเป็นต้องแก้สมการของชเรอดิงเงอร์ (Schrödinger equation) ดังนี้

$$\hat{H}\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2,, \vec{r}_N) = E\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2,, \vec{r}_N)$$
 (2.14)

จากสมการที่ 2.14 เมื่อพิจารณาในระบบหลายอนุภาค N ตัว ใด ๆ จะสามารถมี ระดับขั้นความเสรี (degree of freedom) เป็น 3N ค่า จึงส่งผลให้ทั้งฟังก์ชันคลื่น (wavefunction) และฮามิลโทเนียน (Hamiltonian) มีความซับซ้อนมาก ซึ่งสามารถเขียนฮามิลโทเนียนของระบบ หลายอนุภาคได้ดังนี้

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i} \nabla_i^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{\left|\vec{r}_i - \vec{R}_I\right|} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{e^2}{\left|\vec{r}_i - \vec{r}_j\right|} - \frac{\hbar^2}{2M} \sum_{I} \nabla_I^2 + \sum_{I,J} \frac{Z_I Z_J e^2}{\left|\vec{R}_I - \vec{R}_J\right|}$$
(2.15)

โดยที่ m และ M คือ มวลของอิเล็กตรอนและมวลของนิวเคลียสตามลำดับ

r และ R คือ ตำแหน่งของอิเล็กตรอนและตำแหน่งของนิวไคลด์ (nuclide) ตามลำดับ

ในสมการที่ 2.15 แสดงฮามิลโทเนียน โดยแต่ละเทอม คือ พลังงานจลน์ของ อิเล็กตรอน พลังงานศักย์ระหว่างนิวไคลด์กับอิเล็กตรอน พลังงานศักย์ระหว่างอิเล็กตรอน พลังงาน จลน์ของนิวไคลด์ และพลังงานศักย์ระหว่างนิวไคลด์ตามลำดับ ซึ่งพบว่ามีความซับซ้อนอย่างมาก ทั้งนี้บอร์นและออพเพนไฮเมอร์ (Born and Oppenheimer) [20] ได้เสนอแนวคิดเพื่อประมาณค่า สมการดังกล่าวว่า นิวไคลด์เคลื่อนที่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ดังนั้น สามารถตัดเทอมที่ 4 และเทอมที่ 5 ในสมการที่ 2.15 ได้ เรียกการประมาณค่าดังกล่าวว่าการ ประมาณของบอร์น-ออพเพนไฮเมอร์ (Born-Oppenheimer approximation) ซึ่งแสดงดังสมการ

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i} \nabla_i^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{\left|\vec{r_i} - \vec{R}_I\right|} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{e^2}{\left|\vec{r_i} - \vec{r}_j\right|}$$
(2.16)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการประมาณค่าในสมการที่ 2.16 แล้วก็ตาม ฟังก์ชัน คลื่นในระบบหลายอนุภาคยังคงมีความซับซ้อนอยู่ ทำให้ไม่สามารถแก้สมการชเรอดิงเงอร์ได้ ในปี ค.ศ.1920 โทมัสและเฟร์มี (Thomas and Fermi) [21,22] ได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดย การพิจารณาความหนาแน่นอิเล็กตรอน (electron density, ρ(r)) แทนการพิจารณาฟังก์ชันคลื่น ซึ่งความหนาแน่นอิเล็กตรอนมีความสัมพันธ์กับฟังก์ชันคลื่น ดังนี้

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i} \left| \psi_i(\vec{r}) \right|^2 \tag{2.17}$$

ในปี ค.ศ.1964 โฮเฮนเบิร์กและโคห์น (Hohenberg and Kohn) [23] ได้พิสูจน์ว่า พลังงานรวมที่สถานะพื้น (ground state) ของระบบหลายอนุภาคสามารถเขียนในรูปเชิงฟังก์ชัน ของความหนาแน่นอิเล็กตรอนเท่านั้น ดังแสดงในสมการ

$$E[\rho(\vec{r})] = F[\rho(\vec{r})] + \int v_{ext} \rho(\vec{r}) d^3 \vec{r}$$
(2.18)

เทอมแรก คือ ฟังก์ชันนัลเอกภพ (Universal functional) ซึ่งเป็นเทอมที่บ่งบอกถึง พลังงานของอิเล็กตรอน และเทอมที่สอง เป็นพลังงานที่เกิดจากอันตรกิริยาของอิเล็กตรอนกับนิว ใคลด์

ในปี ค.ศ.1965 โคห์นและชาม (Kohn and Sham) [24] ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาของฟังก์ชันนัล *F*[*p*(*r*)] โดยการพิจารณาว่า เป็นผลรวมของพลังงานจลน์ของ อิเล็กตรอนที่ไม่มีอันตรกิริยาต่อกัน (non-interacting kinetics energy of electrons) และเทอม ของพลังงานที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอน (interacting energy of electrons) โดย สามารถเขียนฟังก์ชันนัลดังกล่าวได้ดังนี้

$$F[\rho(\vec{r})] = T[\rho(\vec{r})] + \frac{1}{2} \int \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|} d^{3}\vec{r} d^{3}\vec{r}' + E_{XC}[\rho(\vec{r})]$$
(2.19)

เทอมที่สอง คือ พลังงานศักย์ไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างอิเล็กตรอน (electrostatics potential energy of electrons) ส่วนเทอมที่สามเป็นพลังงานที่เกิดจากผลของการแลกเปลี่ยน-

สหสัมพันธ์ (exchange-correlation energy) ที่เกิดขึ้นกับระบบอิเล็กตรอน ดังนั้น สามารถเขียน สมการเชิงฟังก์ชันใหม่ เรียกว่า สมการของโคห์น-ชาม (Kohn-Sham equation) โดยแสดงดังนี้

$$E[\rho(\vec{r})] = T[\rho(\vec{r})] + \frac{1}{2} \int \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|} d^3\vec{r} d^3\vec{r}' + E_{xc}[\rho(\vec{r})] + \int v_{ext}\rho(\vec{r}) d^3\vec{r} \qquad (2.20)$$

แม้ว่าพลังงานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ จะไม่สามารถหาค่าได้แบบ แม่นตรงก็ตาม แต่สามารถจะทำการประมาณค่าได้ ดังในงานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้ฟังก์ชันการ แลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ แบบการประมาณค่าเกรเดียนต์โดยนัยทั่วไป (GGA-Generalized Gradient Approximation) ซึ่งแสดงการประมาณค่าของพลังงานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$E_{XC}^{GGA}[\rho(\vec{r})] = \int d^3 \vec{r} f[\rho(\vec{r}), \nabla \rho(\vec{r})]$$
(2.21)

เมื่อ $f[
ho(ec{r}),
abla
ho(ec{r})]$ เป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์เชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นฟังก์ชัน ของความหนาแน่นอิเล็กตรอนและเกรเดียนต์ของความหนาแน่นอิเล็กตรอน

ทั้งนี้สามารถเขียนสมการของโคห์น-ชาม ในรูปสมการชเรอดิงเงอร์ของอิล็กตรอน ตัวที่ *i* ใด ๆ ได้ดังนี้

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{eff}(\vec{r})\right]\psi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\vec{r})$$
(2.22)

โดยที่ศักย์ยังผล (effective potential, $V_{\scriptscriptstyle eff}$) สามารถแสดงได้เป็น

$$V_{eff}[\vec{r}] = V_{ext}(\vec{r}) + V_{ee}(\vec{r}) + V_{XC}(\vec{r})$$
(2.23)

โดยที่ เทอมแรกแทนศักย์ที่มาจากนิวไคลด์ เทอมที่สองแทนศักย์ที่เกิดจาก อิเล็กตรอน และเทอมที่สามแทนศักย์ที่มาจากการแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าศักย์ยังผลมีความสัมพันธ์กับทั้งความ หนาแน่นอิเล็กตรอนและฟังก์ชันคลื่น ทั้งนี้การแก้สมการของโคห์น-ชามเหมาะสำหรับกับเทคนิค การวนซ้ำ (iterative technique) เพื่อหาคำตอบด้วยวิธีสนามต้องกันในตัว (self-consistent field) ดังขั้นตอนที่แสดงในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนการแก้สมการของโคห์น-ชามด้วยเทคนิคการวนซ้ำและพิจารณาคำตอบด้วยวิธี สนามต้องกันในตัว

สำหรับโครงสร้างผลึกที่มีลักษณะแบบซ้ำเป็นคาบ (periodic structure) ฟังก์ชัน คลื่นที่เหมาะสม คือ คลื่นระนาบ (plane wave) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทของบลอค (Bloch's theorem) แสดงดังสมการ

$$\begin{split} \psi_{j}(\vec{r}) &= f_{j}(\vec{r}) \exp[i\vec{k}.\vec{r}] \\ &= \left\{ \sum_{G} c_{j,\bar{G}} \exp[i\vec{G}.\vec{r}] \right\} \exp[i\vec{k}.\vec{r}] \\ &= \sum_{G} c_{j,\bar{G}+\bar{k}} \exp[i(\vec{G}+\vec{k}).\vec{r}] \end{split}$$
(2.24)
เมื่อ \vec{k} คือ เวกเตอร์คลื่น (wave vector)

 $ar{G}$ คือ เวกเตอร์ของแลตทิซส่วนกลับ (reciprocal lattice vector)

นอกจากนี้พบว่า การคำนวณเพื่อแก้สมการของโคห์น-ชาม นั้น อันตรกิริยาใน บริเวณของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้กับนิวไคลด์หรืออิเล็กตรอนแกน (core electron) ต้องอธิบายด้วย ฟังก์ชันคลื่นที่มีความถี่สูง เป็นผลให้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันคลื่นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและ เวลาในการคำนวณมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.1982 ไคลน์แมนและบายแลนเดอร์ (Kleinman and Bylander) [25] ได้เสนอแนวคิดของศักย์เทียม (pseudopotential) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการแทนฟังก์ชันคลื่นจริงด้วยฟังก์ชันคลื่นเทียม (pseudo-wavefunction) และแทนศักย์จริง ด้วยศักย์เทียมซึ่งลักษณะทางกายภาพจากแนวคิดของศักย์เทียมแสดงในภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 ฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนและศักย์ที่เกิดจากนิวไคลด์กับอิเล็กตรอนจริง (เส้นทึบ) จะถูกประมาณค่าด้วยฟังก์ชันคลื่นเทียมและศักย์เทียม(เส้นประ) ที่ระยะ r < r_c ซึ่งเป็น ระยะที่พิจารณาว่าอิเล็กตรอนที่ระยะดังกล่าวทำหน้าที่เป็นอิเล็กตรอนแกน

บทที่ 3

เทคนิคการทดลองและการคำนวณ

3.1 เทคนิคการศึกษาโครงสร้างที่ความดันสูง

สำหรับการทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมใน งานวิจัยนี้ ได้ส่งสารตัวอย่างไปทำการทดลองที่ The Daresbury Synchrotron Radiation Source (SRS) สหราชอาณาจักร ด้วยความยาวคลื่น 0.46540 Å และ 0.44397 Å ได้ใช้ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์แบบเมอร์ริลล์-แบสเสทท์ (Merrill-Bassett, MB) เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดัน การวัดความดัน ได้ใช้เทคนิคการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ในทับทิม และใช้อิมเมจเพลตเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกแถบ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ซึ่งมีแผนภาพการจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 การจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจาย มุมที่ The Daresbury Synchrotron Radiation Source [26]

สำหรับเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม และหลักการทำงาน ของอิมเมจเพลต ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 2 ดังนั้นในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการเพิ่มความดัน และหลักการวัดความดันเท่านั้น

3.1.1 ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ (DAC)

ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดัน ที่ใช้กับการทดลองที่ความดัน สูงอย่างแพร่หลาย ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 ส่วนประกอบหลักของ ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ ประกอบด้วยเพชรที่มีหน้าตัดเท่ากัน 2 เม็ด ปะเก็นโลหะ (metal gasket) โดยขั้นตอนการ เตรียมการทดลอง เริ่มจากการบรรจุตัวอย่างผงผลึก ผลึกของทับทิม และสารส่งผ่านความดัน (pressure transmitting medium) ซึ่งใช้เป็นสารผสมระหว่างเมทานอลและเอทานอลในอัตราส่วน 4 : 1 ในห้องสารตัวอย่าง (sample chamber) สำหรับการเพิ่มความดันทำได้โดยส่งแรงกลผ่าน หน้าตัดภายนอกของเพชรทั้งสองข้าง ดังแสดงในภาพที่ 3.2





สำหรับในงานวิจัยนี้ได้ใช้ ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ แบบเมอร์ริลล์-แบสเสทท์ ซึ่งได้ แสดงส่วนประกอบในภาพที่ 3.3 [28]



ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ แบบเมอร์ริลล์-แบสเสทท์ ซึ่ง ประกอบด้วย (1) ตัวโครงของไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ ซึ่งทำจากสเตนเลส (2) จาน เบอรีเลียม (3) ปะเก็นโลหะซึ่งทำจากโลหะทังสเตน และ (4) ผลึกของเพชร



ภาพที่ 3.4 โพรไฟล์ของพีคความยาวคลื่น R₁ และ R₂ ที่ความดันต่าง ๆ ดังนี้ โพรไฟล์ A : ที่ความ ดันบรรยากาศ โพรไฟล์ B : ที่ความดัน 22.3 kbar และโพรไฟล์ C : ที่ความดัน 40.0 kbar

การวัดความดันในงานวิจัยนี้ ได้ใช้เทคนิคการวัดค่าการเลื่อนความยาวคลื่นที่เกิด จากการฟลูออเรสเซนซ์ในผลึกของทับทิมเมื่อมีการถูกกระตุ้นด้วยเลเซอร์ He-Cd ซึ่งความยาว คลื่นที่เกิดจากการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ จะมีความสัมพันธ์กับความดัน โดยที่เมื่อความดันมากขึ้นจะ ทำให้ความยาวคลื่นมากขึ้น หรือเลขคลื่นน้อยลงนั่นเอง ดังได้แสดงในภาพที่ 3.4 ทั้งนี้พบว่าความ ยาวคลื่น R₁ จะมีความแม่นยำในการวัดความดันมากกว่าความยาวคลื่น R₂ เนื่องจากลักษณะพีค ที่เด่นซัดและความเข้มที่มากกว่า ในการทดลองในงานวิจัยนี้ใช้ผลึกของทับทิมที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 10 μm บรรจุไว้กับผงผลึกตัวอย่างที่ต้องการศึกษา สำหรับการวัด ค่าความดันทำโดยการวัดค่าความยาวคลื่นที่เกิดจากการฟลูออเรสเซนซ์ แล้วเปรียบเทียบกับค่า ความยาวคลื่นที่เกิดจากการฟลูออเรสเซนซ์ของทับทิมที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งเท่ากับ 6,942 Å โดยความดันสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังสมการสถานะ ดังนี้

$$P(kbar) = \frac{19040}{B} \left[\left(\frac{\Delta \lambda}{694.2 \, nm} + 1 \right)^B - 1 \right]$$
(3.1)

เมื่อ ∆ิ คือผลต่างของความยาวคลื่นฟลูออเรสเซนซ์ของทับทิมที่เปลี่ยนไปเมื่อ เทียบกับความยาวคลื่นฟลูออเรสเซนซ์ที่ความดันบรรยากาศ โดยที่ B มีค่าเป็น 5.000 เมื่อการเพิ่ม ความดันเป็นแบบไม่อุทกสถิตยศาสตร์ (non-hydrostatics) และมีค่าเป็น 7.665 เมื่อการเพิ่ม ความดันเป็นแบบอุทกสถิตยศาสตร์ (hydrostatic) ซึ่งค่า B ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสารส่งผ่านความดัน ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้สารผสมระหว่างเมทานอลกับเอทานอลในอัตราส่วน 4:1 ซึ่งพบว่าการเพิ่ม ความดันเป็นแบบอุทกสถิตยศาสตร์ [29] สำหรับแผนภาพการวัดความดันในงานวิจัยนี้ ดังแสดง ในภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แผนภาพเทคนิคการวัดความดันโดยใช้เลเซอร์กระตุ้นผลึกทับทิมที่อยู่ในไดมอนด์ แอน วิล เซลล์ และแสงจากการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ จะถูกส่งกลับมาประมวณผลด้วย สเปกโทรมิเตอร์ (ซ้าย) [26] การจัดเรียงอุปกรณ์จริงที่ใช้สำหรับการวัดความดัน (ขวา)

3.2 หลักการและขั้นตอนการคำนวณด้วย DFT

ในงานวิจัยนี้นอกจากการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างสารด้วยเทคนิคการเลี้ยว เบนของรังสีเอกซ์ซนิดกระจายมุมภายใต้ความดันสูงแล้ว ในสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ยังได้ศึกษาการ เปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งโดยการคำนวณด้วย DFT ซึ่งได้อธิบายทฤษฏีไว้แล้วในบทที่ 2 โดย การศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบและ สนับสนุนผลการทดลอง ในการคำนวณได้ใช้โปรแกรม CASTEP โดยใช้ฟังก์ชัน GGA-PBE และ ศักย์เทียมแบบอุลตราซอฟท์ (ultrasoft pseudopotential) สำหรับเงื่อนไขของการศึกษาสารกึ่ง ตัวนำ AgInTe₂ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาและงานวิจัยนี้เอง ที่พบว่าโครงสร้างที่ความดันสูงของ สารกึ่งตัวนำกลุ่มนี้มีโครงสร้างแบบมีการจัดเรียงของไอออนบวกแบบสุ่ม (cation disordered structure) โดยโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสำหรับการคำนวณที่ต้องจำลองโครงสร้างเป็นซุปเปอร์ เซลล์ (supercell) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ทรัพยากรและเวลาในการคำนวณค่อนข้างมาก เป็นเหตุผลทำ ให้ผู้วิจัยพยายามหาวิธีการคำนวณโดยพิจารณาถึงเรื่องทรัพยากรและเวลาเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการ คำนวณด้วย 2 วิธี ซึ่งมีความแตกต่างของโครงสร้างที่ความดันสูง ได้แก่

การคำนวณด้วยวิธีจีโอเมทรีออพทิไมเซชัน (Geometry Optimization calculation) โดยโครงสร้างที่ใช้ในการคำนวณเป็นโครงสร้างขนาดหนึ่งหน่วยเซลล์ ในโครงสร้างที่ ความดันสูงทำการสุ่มอะตอมของ Ag และ In ในอัตราส่วน 1 : 1 ซึ่งค่อนข้างมีข้อจำกัดในการสุ่ม อะตอม ทั้งนี้ในการคำนวณด้วยวิธีจีโอเมทรีออพทิไมเซชัน ยอมให้มีการปรับตัวแปรโครงสร้างทั้ง ตำแหน่งอะตอมและค่าคงที่แลตทิซ ตามเงื่อนไขของความดันที่กำหนด เพื่อหารูปแบบโครงสร้างที่ เสถียรที่สุด

 การคำนวณด้วยวิธีพลังงานจุดเดียว (Single Point Energy calculation) ซึ่ง
 วิธีดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่จำลองขึ้นในเบื้องต้น แต่จะทำการคำนวณหา พลังงานเท่านั้น ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โครงสร้างซุปเปอร์เซลล์ (supercell structure) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
 ที่เหมาะต่อการศึกษาระบบที่ไม่เป็นระเบียบ (disorder system) ดังนั้นในสาร AgInTe₂ ซึ่งพบว่ามี
 โครงสร้างที่ความดันสูงเป็นโครงสร้างที่มีตำแหน่งของไอออนบวกแบบสุ่มนั้น โครงสร้างแบบ
 ซุปเปอร์เซลล์จึงสามารถสุ่มตำแหน่งอะตอมของ Ag และ In ได้แบบอัตโนมัติด้วยอัตราส่วน 1 : 1

ทั้งนี้ ผลที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนโครงสร้างทั้งสองวิธี คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างพลังงานและปริมาตร ซึ่งจะทำการปรับกับสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่ สอง เพื่อทำการวิเคราะห์ และหาตัวแปรสถานะที่บ่งบอกถึงสมบัติการเปลี่ยนโครงสร้างและนำไป เปรียบเทียบกับผลการทดลองต่อไป

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์และผลการคำนวณ

ในการศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ และ AgGaTe₂ ภายใต้ความดันสูงใน งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจาย มุม และการคำนวณด้วย DFT

สารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจาย มุมในกระบวนการเพิ่มความดันจากความดันบรรยากาศจนถึงความดันประมาณ 26 GPa และใน กระบวนการลดความดันกลับสู่ความดันบรรยากาศอีกครั้ง ทั้งนี้ได้ทำการคำนวณด้วย DFT ในการ เปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่ง และสำหรับสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมในกระบวนการเพิ่มความดันจากความดันบรรยากาศจนถึงความดัน 10 GPa และในกระบวนการลดความดันกลับสู่ความดันบรรยากาศ ทั้งนี้ผลการทดลองและผลการ คำนวณ ของสารทั้งสองได้แสดง โดยจะแยกกล่าวเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

4.1 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe $_2$

4.1.1 โครงสร้างของสาร AgInTe₂ที่ความดันบรรยากาศ



4.1.1.1 ผลการทดลองจากเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม

ภาพที่ 4.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มกับมุมของแบร็กก์ของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ที่ ความดันบรรยากาศ ซึ่งยอดที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (+) เป็นยอดของโครงสร้างร่วมที่ ปรากฏขึ้น นอกจากยอดที่ระบุว่าเป็นโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ มีโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ หมู่สมมาตร I42d โดยที่มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.406 Å และ c = 12.560 Å พารามิเตอร์ภายใน u = 0.25 และ η = 1.96 ทั้งนี้จากภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มกับมุมของ แบร็กก์ จากการทดลองด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม โดยใช้รังสีเอกซ์ที่มีความ ยาวคลื่นเป็น 0.44397 Å พบว่าโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ เป็นแบบซาลโคไฟไรท์มี ค่าคงที่แลตทิซ a = 6.396 Å และ c = 12.615 Å มีค่าพารามิเตอร์ภายในเป็น u = 0.24 และ η = 1.97 ทั้งนี้โครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ที่กล่าวในเบื้องต้น ยังไม่สามารถระบุตามโพรไฟล์ดัง ภาพที่ 4.1 ได้ครบถ้วนทุกยอด ซึ่งยอดดังกล่าวระบุด้วยเครื่องหมาย (+) ทั้งนี้ผลจากการปรับ โครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ พบว่าโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ที่มีค่าคงที่ แลตทิซ a = 6.262 Å สามารถปรับได้ดี โดยมีค่า R_{wp} = 3.85 % และค่า R_p = 2.87 % ดังแสดง ในภาพ



ภาพที่ 4.2 กราฟการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ที่ความดันบรรยากาศด้วยโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์และโครงสร้างแบบ ซิงค์เบลนด์

ตำแหน่งอะตอมของโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ดังกล่าว ได้ทำการระบุเป็น โครงสร้างที่มีไอออนบวกเรียงตัวแบบสุ่ม โดยตำแหน่งอะตอมของโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ ซึ่ง เป็นโครงสร้างร่วม แสดงดังตารางที่ 4.1

ธาตุ	ตำแหน่ง	อะตอมโดย		
	u	V	W	occupancy
Ag	0.00	0.00	0.00	0.5
In	0.00	0.00	0.00	0.5
Те	0.25	0.25	0.25	1.0

ตารางที่ 4.1 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe₂ ที่มีโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์

ถึงแม้โครงสร้างที่ความดันบรรยากาศของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ จะมีโครงสร้าง ร่วมเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ทำให้ส่งผลกับการศึกษาโครงสร้างของ AgInTe₂ ที่ความดันสูงแต่อย่างใด ซึ่ง จะแสดงให้เห็นในหัวข้อ 4.1.2 ต่อไป ทั้งนี้โครงสร้างร่วมดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแรงจ์ และคณะ (K.J Range, *et al*) [30] ในการศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ภายใต้ความดันสูงและ อุณหภูมิสูง ซึ่งเขาพบว่าเกิดโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์เป็นโครงสร้างอุปเสถียร (metastable structure) ขึ้นในกระบวนการลดความดันและลดอุณหภูมิสู่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิห้อง

4.1.1.2 ผลการคำนวณด้วย DFT

ในการคำนวณโครงสร้างของสาร AgInTe₂ ด้วย DFT ได้ทำการคำนวณหา พลังงานคัทออฟฟ์ (Energy cut-off) ซึ่งเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงจำนวนของฟังก์ชันคลื่นหรือ ทรัพยากรที่ใช้ในการคำนวณ โดยใช้เทคนิคการลู่เข้าของพลังงาน (Energy convergence technique) ซึ่งพิจารณาสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ที่มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.396 Å และ c = 12.615 Å ที่ได้จากผลการทดลองโดยใช้ฟังก์ชั่น GGA-PBE และศักย์เทียมแบบอุลตราซอฟท์ ดังแสดงใน ภาพที่ 4.3





จากภาพที่ 4.3 พบว่า ที่พลังงานคัทออฟฟ์เท่ากับ 350 eV พลังงานรวมเริ่มลู่เข้า หาค่า -3048.91 eV/molecule ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าการเลือกใช้ค่าพลังงานคัทออฟฟ์ เท่ากับ 400 eV จะทำให้ได้ผลการคำนวณที่น่าเชื่อถือ

การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ และตำแหน่งอะตอมที่ความดันบรรยากาศ ใช้การ คำนวณแบบจีโอเมทรีออพทิไมเซชัน ซึ่งในการคำนวณนี้ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งค่า ตำแหน่งอะตอมและค่าคงที่แลตทิซ โดยเริ่มจากโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ที่มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.396 Å และ c = 12.615 Å มีค่าพารามิเตอร์ภายใน u = 0.24 และ η = 1.97 ซึ่งผลการ คำนวณพบว่าโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ที่ได้จะมีค่าคงที่แลตทิซยืดออกเป็น a = 6.497 Å และ c = 12.821 Å แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ภายในซึ่งบ่งบอกตำแหน่งของอะตอม 4.1.2 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งของสาร AgInTe,



4.1.2.1 ผลการทดลองจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม

ภาพที่ 4.4 โพรไฟล์ของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgInTe₂ในกระบวนการ เพิ่มความดันจากความดันบรรยากาศถึงความดัน 6.25 GPa

จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า จากความดันบรรยากาศถึงความดัน 2.84 GPa โพรไฟล์ของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ทุกยอดจะเลื่อนไปในทิศทางที่มีมุมของ แบร็กก์มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าในช่วงดังกล่าวสาร AgInTe₂ ยังมีโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ และโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์เป็นโครงสร้างร่วม แต่โครงสร้างทั้งสองมีค่าคงที่แลตทิซลดลงเมื่อ เทียบกับการเพิ่มความดัน

ที่ความดัน 4.14 GPa พบว่าโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ไม่ปรากฏในโพรไฟล์และ มียอดใหม่เกิดขึ้นที่มุมของแบร็กก์ ประมาณ 7.9°, 9°, 13°, 16°, 18.3°, 20° และ 22° ซึ่งระบุด้วย เครื่องหมาย (*) และเมื่อพิจารณาโพรไฟล์ที่ความดัน 6.20 GPa พบว่ายอดที่แสดงถึงโครงสร้าง แบบซาลโคไพไรท์ไม่ปรากฏในโพรไฟล์ เหลือเพียงยอดใหม่ที่กล่าวไว้ในข้างต้น ทำให้สามารถสรุป ได้ว่าทั้งโครงสร้างแบบซาลโคไพไรท์และโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบ ใหม่ ซึ่งระบุด้วยเครื่องหมาย (*) ที่ความดันประมาณ 3 - 4 GPa โดยที่โครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ เปลี่ยนไปเป็นเป็นโครงสร้างแบบใหม่สมบูรณ์ที่ความดันประมาณ 4.14 GPa และโครงสร้างผลึก แบบซาลโคไพไรท์เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบใหม่สมบูรณ์ที่ความดันประมาณ 6.25 GPa จากการคำนวณระบุโครงสร้างด้วยโปรแกรม DICVOLO4 โดยใช้โพรไฟล์จากการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม ที่ความดัน 6.25 GPa พบว่าทุกยอดในโพรไฟล์สอดคล้อง กับโครงสร้างแบบลูกบาศก์ที่มีค่าคงที่แลตทิช a = 5.827 Å และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่าน มา ซึ่งพบว่าสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ จะเปลี่ยนโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ไปเป็นโครงสร้างแบบ คล้าย NaCl ที่มีจัดเรียงตำแหน่งของไอออนบวกแบบสุ่ม ทั้งนี้จากการพิจารณาความสมมาตรที่ เกิดขึ้นในยอดจากผลการทดลองซึ่งแสดงดังภาพที่ 4.5 พบว่าทุกยอดมีอสมมาตรเกิดขึ้นและมี ฟูลล์ วิดท์ ฮาล์ฟ แมกซิมัม (Full Width Half Maximum, FWHM) ค่อนข้างมาก ทำให้พิจารณาได้ ว่ายอดที่เกิดขึ้นเกิดจากการซ้อนทับกันของยอดหลายยอด โดยที่โครงสร้างที่เป็นไปได้ต้องเป็น โครงสร้างที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตใกล้เคียงกับโครงสร้างแบบคล้าย NaCi ซึ่งในที่นี้ก็คือโครงสร้าง แบบออร์โทรอมบิก ที่มีหมู่สมมาตรเป็น *Cmcm* โดยที่มีพารามิเตอร์ภายในของอะตอม Ag และ In เป็น v = 0.75 และของอะตอม Te เป็น v = 0.25



โครงสร้างแบบคล้าย NaCl (บน) และโครงสร้างแบบ *Cmcm* (ล่าง)

จากภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปร โครงสร้างของริทเวลด์ โดยภาพที่ 4.5 (บน) เป็นการปรับโครงสร้างแบบคล้าย NaCl ที่มีค่าคงที่ แลตทิชเป็น 5.870 Å โดยมีค่า $R_{wp} = 4.37$ % และค่า $R_p = 3.14$ % ส่วนภาพที่ 4.5 (ล่าง) เป็น การปรับโครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่มีค่าคงที่แลตทิชเป็น a = 5.871 Å, b = 5.798 Å และ c = 5.808 Å โดยผลการปรับมีค่า $R_{wp} = 3.45$ % และค่า $R_p = 2.62$ % ทั้งนี้จากการพิจารณา เปรียบเทียบค่า R_{wp} และค่า R_p รวมทั้งแถบผลต่างผลการทดลองและโครงสร้างที่จำลองขึ้นเพื่อ ปรับตัวแปรโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ ซึ่งแสดงดังเส้นสีน้้ำเงินพบว่า โครงสร้างแบบ *Cmcm* สามารถปรับกับโพรไฟล์ได้ดีกว่าโครงสร้างแบบคล้าย NaCl เพราะจาก ค่าคงที่แลตทิชของโครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่ $a \neq b \neq c$ ทำให้ทุกยอดที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยวเบนที่ มุมของแบร็กก์ต่างกันเล็กน้อย ทำให้มีอสมมาตรเกิดขึ้นและ FWHM ค่อนข้างมาก ทำให้โครงสร้าง แบบ *Cmcm* สามารถปรับได้ดีกว่าโครงสร้างแบบคล้าย NaCl



ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของสาร AgInTe₂ ที่ได้จากการ ปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์และทำการปรับ ข้อมูลด้วยสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สอง

จากภาพที่ 4.6 พบว่า โครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์มีค่ามอดูลัสเซิงปริมาตร เท่ากับ 34.01 GPa และโครงสร้างแบบ *Cmcm* มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตรเท่ากับ 57.52 GPa ทั้งนี้ การเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์เป็นโครงสร้างแบบ Cmcm มีปริมาตรลดลง ประมาณ 14 %

4.1.2.2 ผลการคำนวณด้วย DFT

นอกจากการพิจารณาการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่ง ของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ที่ได้จากผลการทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมแล้ว ได้ทำการ คำนวณด้วย DFT ซึ่งได้ใช้พารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการคำนวณที่พิจารณาจากผลการทดลองเป็น หลัก สำหรับโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ ได้ทำการคำนวณด้วยโครงสร้างที่มีตำแหน่งอะตอมโดย สัดส่วน ดังแสดงในตาราง 4.2

ตารางที่ 4.2 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe₂ ที่มีโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรท์ โดยการ จัดเรียงอะตอมด้วยชุดตัวดำเนินการของโครงสร้างที่มีหมู่สมมาตร I42d

ธาตุ	ດຳນວນລະຫລາ	ตำแหน่งอะตอมโดยสัดส่วน			
	1 16 3 6 0 0 10 6	u	v	W	
Ag	4	0.000	0.000	0.000	
In	4	0.000	0.000	0.500	
Te	8	0.240	0.250	0.125	

แต่สำหรับโครงสร้างที่ความดันสูง ที่ข้อมูลจากผลการทดลองระบุว่าโครงสร้างที่ เกิดขึ้นเป็นโครงสร้างที่มีการเรียงตัวของไอออนบวกแบบสุ่ม ดังนั้นทำให้มีการพิจารณาสร้าง แบบจำลองขึ้นมาและทำการคำนวณด้วย DFT เพื่อสนับสนุนผลการทดลองที่ได้จากเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมในการเกิดโครงสร้างดังกล่าว โดยการคำนวณโครงสร้าง ดังกล่าวได้คำนวณเปรียบเทียบด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การคำนวณด้วยวิธีจีโอเมทรีออบทิไมเซชัน ซึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการ คำนวณเป็นโครงสร้างขนาดหนึ่งหน่วยเซลล์ โดยเริ่มจากการสร้างโครงสร้างแบบคล้าย NaCl จาก อะตอมของ Ag และ Te จากนั้นก็เปลี่ยนโครงสร้างที่สร้างขึ้นให้เป็นโครงสร้างที่มีหมู่สมมาตรเป็น P1 แล้วแทนตำแหน่งอะตอมของ Ag ด้วยอะตอมของ In ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยที่ตำแหน่งอะตอม ดังแสดงในตารางที่ 4.3 สำหรับการคำนวณด้วยวิธีจีโอเมทรีออบทิไมเซชันในการคำนวณนี้ ยอม ให้มีการเปลี่ยนค่าคงที่แลตทิซได้ แต่จะจำกัดค่าตำแหน่งอะตอมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ผลการ คำนวณพบว่าโครงสร้างแบบลูกบาศก์เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบเททระโกนัล ที่มีหมู่สมมาตร เป็น P4/mmm โดยที่ตำแหน่งของอะตอมยังคงจัดเรียงแบบเดียวกับตำแหน่งอะตอมของโครงสร้าง แบบคล้าย NaCl

60.00	จำนวน	ตำแหน่งอะตอมโดยสัดส่วน			
	อะตอม	u	V	w	
Ag	1	0.000	0.000	0.000	
Ag	1	0.500	0.500	0.000	
In	1	0.500	0.000	0.500	
In	1	0.000	0.500	0.500	
Те	1	0.500	0.500	0.500	
Те	1	0.500	0.000	0.000	
Те	1	0.000	0.500	0.000	
Те	1	0.000	0.000	0.500	

ตารางที่ 4.3 ตำแหน่งอะตอมของสาร AgInTe₂ ที่มีโครงสร้างแบบคล้าย NaCI โดยการ จัดเรียงอะตอมด้วยชุดตัวดำเนินการของโครงสร้างที่มีหมู่สมมาตร P1



แบบเททระโกนัล ที่มีหมู่สมมาตรเป็น P4/mmm

จากภาพที่ 4.7 พบว่าโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์เปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบ P4/mmm โดยการพิจารณาจากเส้นตรงที่สัมผัสโครงสร้างทั้งสอง ทั้งนี้ได้ปรับความสัมพันธ์ ระหว่างพลังงานรวมและปริมาตร ด้วยสมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สอง ผลการ คำนวณพบว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างเกิดขึ้นที่ความดันประมาณ P = 4.01 GPa มีปริมาตรลดลง ประมาณ 19 % โดยที่โครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตรเท่ากับ 38.04 Pa และ โครงสร้างแบบ P4/mmm มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตรเท่ากับ 51.89 GPa

แม้ว่าโครงสร้างที่ความดันสูงที่ได้จากการคำนวณนี้มีหมู่สมมาตรต่างจากผลการ ทดลอง แต่พบว่าตำแหน่งอะตอมของโครงสร้างแบบ P4/mmm นี้ มีการจัดเรียงตำแหน่งอะตอมใน ลักษณะเดียวกับโครงสร้างแบบ Cmcm ซึ่งทั้งสองโครงสร้างมีตำแหน่งอะตอมจัดเรียงแบบ โครงสร้าง NaCl ทั้งนี้ ข้อแตกต่างของโครงสร้างแบบ P4/mmm จากโครงสร้างแบบ Cmcm ก็คือ ในโครงสร้างแบบ P4/mmm มีค่าคงที่แลตทิซ a = b≠ cในขณะที่โครงสร้างแบบ Cmcm มีค่าคงที่ แลตทิซ a≠b≠c แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของ c/a = 1.012 และ c/b = 1.011 ซึ่งทำให้ ค่า a มีค่าใกล้เคียงกับค่า b จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้างแบบ Cmcm ที่ได้จาก การทดลอง มีค่าใกล้เคียงกับโครงสร้างแบบ P4/mmm ในการคำนวณนี้

วิธีที่ 2 การคำนวณด้วยวิธีพลังงานจุดเดียว ซึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการคำนวณเป็น โครงสร้างแบบซุปเปอร์เซลล์ของ *Cmcm* ที่มีมิติเป็น 2x2x2 ดังนั้นโครงสร้างที่ใช้ในการคำนวณ ทั้งสิ้น 8 เซลล์ ซึ่งมีการสุ่มตำแหน่งอะตอมของ Ag และ In ในอัตราส่วน 1 : 1 ดังแสดงในภาพที่ 4.8 สำหรับการคำนวณด้วยวิธีพลังงานจุดเดียว เป็นวิธีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งค่าคงที่แลตทิซ และตำแหน่งของอะตอม ผลการคำนวณซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรวมและปริมาตร แสดงดังภาพที่ 4.9 พบว่าเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ไปเป็น โครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่ความดันประมาณ 3.80 GPa มีปริมาตรลดลงประมาณ 17 % โดยที่ โครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์มีค่ามอดูลัสเซิงปริมาตรเท่ากับ 43.26 GPa และโครงสร้างแบบ *Cmcm* มีค่ามอดูลัสเซิงปริมาตรเท่ากับ 52.87 GPa



ภาพที่ 4.8 โครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่มีีมิติ เป็น 2x2x2 และมีตำแหน่งอะตอมเหมือนกับ โครงสร้างแบบคล้าย NaCl



ภาพที่ 4.9 กราฟพลังงานรวมและปริมาตรของโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์และโครงสร้าง แบบซุปเปอร์เซลล์ของ Cmcm

ในการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ทั้งจากผลการ ทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมและการคำนวณด้วย DFT ทั้งสองวิธี ได้แสดงดังตารางที่ 4.4 พบว่าทั้งการทดลองและการคำนวณด้วย DFT มีการเปลี่ยนโครงสร้าง เกิดขึ้นที่ความดันในช่วงประมาณ 3 ถึง 4 GPa และโครงสร้างที่สองที่เกิดขึ้นมีการเรียงตัวของ ไอออนบวกแบบสุ่ม และมีตำแหน่งของอะตอมคล้ายกับตำแหน่งของอะตอมในโครงสร้างแบบ คล้าย NaCl ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่าผลการคำนวณด้วย DFT สอดคล้องและสามารถสนับสนุนผลการ ทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมได้เป็นอย่างดี

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งจากผลการคำนวณด้วย DFT ทั้งสองวิธี (GO : Geometry Optimization และ SPE : Single Point Energy) และผลจากการ ทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม (ADXRD)

ความดันบรรยา		รรยากาศ	การเปลี่ยนโครงสร้าง		ความดันสูง		
วิธีการ	โครงสร้าง	B₀(GPa)	ความดัน	ปริมาตรที่	โครงสร้าง	B₀(GPa)	
		0((-)		ରଉରଏ		-0(
ADXRD	СН	34.01	3.0-4.0 GPa	14 %	Cmcm	57.51	
GO	СН	38.04	4.01 GPa	19 %	P4/mmm	51.89	
SPE	СН	43.26	3.90 GPa	17 %	Стст	52.87	



4.1.3 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองของสาร AgInTe₂



จากภาพที่ 4.10 พบว่าที่ความดัน 18.65 GPa โครงสร้างของสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ ยังเป็นโครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่มีตำแหน่งอะตอมคล้ายกับโครงสร้างแบบคล้าย NaCl ที่ กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น ทั้งนี้ที่ความดันดังกล่าวพบว่ามียอดของทังสเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นปะเก็น ในไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ โดยมีโครงสร้างแบบ CsCl ที่มีค่าคงที่แลตทิซเป็น a = 3.099 Å ร่วมมา ด้วย เมื่อความดันถึง 21.70 GPa จะพบว่ามียอดใหม่เกิดขึ้นซึ่งระบุด้วยเครื่องหมาย (+) แต่ จนกระทั่งความดันถึง 25.97 GPa พบว่ายอดเดิมยังคงปรากฏร่วมกับยอดใหม่ซึ่งหมายความว่า อาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างโดยการบิดเบี้ยวไปจากโครงสร้างเดิมเท่านั้น ซึ่งมีแนวโน้มคล้ายคลึง กับการศึกษาสารกึ่งตัวนำ CuInSe₂ ภายใต้ความดันสูง ของวราลักษณ์ แสงสุวรรณ [20] ซึ่งเป็น สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างที่ความดันบรรยากาศเป็นโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์เช่นเดียวกับสาร กึ่งตัวนำ AgInTe₂ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าในการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สอง สารกึ่งตัวนำ CuInSe₂ เปลี่ยนจากโครงสร้างแบบคล้าย NaCl ไปเป็นโครงสร้างแบบ *Cmcm* โดยการบิดของ ระนาบ (002) ไปในทิศทาง [010] จากการระบุโครงสร้างของ AgInTe₂ ที่ความดัน 21.70 GPa ด้วยโปรแกรม DICVOL04 พบว่าโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิกที่มีค่าคงที่แลซทิซ a = 5.724 Å b = 5.621 Å และ c = 5.548 Å สามารถระบุกับยอดในโพรไฟล์จากการทดลองได้ดี จึงทำให้มีความเป็นไปได้ ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองในสาาร AgInTe₂ จะมีแนวโน้มคล้ายคลึงกับการเปลี่ยน โครงสร้างของสาร CuInSe₂



ภาพที่ 4.11 โพรไฟล์ของการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ ของสาร AgInTe₂ ที่ความดัน 21.70 GPa ด้วยโครงสร้างแบบ *Cmcm* และโครงสร้างแบบ CsCl ของทังสเตน

จากภาพที่ 4.11 พบว่าที่ความดัน 21.70 GPa โครงสร้างแบบออทอร์รอมบิคที่มี หมู่สมมาตรเป็น *Cmcm* มีค่าพารามิเตอร์ภายในของอะตอม Ag และ In เป็น v = 0.674 และ อะตอมของ Te เป็น v = 0.185 และมีค่าคงที่แลตทิซเป็น a = 5.563 Å, b = 5.744 Å และ c = 5.581 Å ร่วมกับทังสเตนที่มีโครงสร้างแบบ CsCI สามารถปรับได้ดีกับผลการทดลอง โดย พิจารณาจากแถบผลต่างระหว่างผลการทดลองและการคำนวณที่ค่อนข้างน้อย และผลการปรับมี ค่า R_{wp} = 3.25 % และค่า R_p = 2.41 % จึงทำให้สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่ สองในสาร AgInTe₂ เกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 21.70 GPa โดยเปลี่ยนโครงสร้างด้วยการบิดไป ของอะตอมในระนาบ (002) ในทิศทาง [010] ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกับสาร CuInSe₂ ทั้งนี้หมู่สมมาตร ของสารAgInTe₂ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายใน ซึ่งบ่งบอกตำแหน่ง อะตอมของสาร โดยการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองของสาร AgInTe₂ แสดงในภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สองของสาร AgInTe₂ โดยมีการเลื่อนระนาบ (002) ไป ในทิศทาง [010] โดยหมู่สมมาตรยังคงเป็น *Cmcm*



4.1.4 การเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการลดความดัน

จากความดัน 10.25 GPa ถึงความดันบรรยากาศ

จากภาพที่ 4.13 ในกระบวนการลดความดัน พบว่าโครงสร้างแบบ *Cmcm* ที่มี ตำแหน่งอะตอมแบบคล้าย NaCl ยังคงเสถียร จนกระทั่งถึงความดัน 0.55 GPa พบว่าเริ่มมีการ เปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบ *Cmcm* กลับไปเป็นโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ที่มีค่าคงที่ แลตทิซเป็น a = 6.396 Å และ c = 12.441 Å ซึ่งทั้งความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างและ ค่าคงที่แลตทิซของโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ในกระบวนการลดความดันมีค่าแตกต่างจาก กระบวนการเพิ่มความดัน

จากกระบวนการเพิ่มความดันในหัวข้อ 4.1.1 ที่พบว่าโครงสร้างที่ความดัน บรรยากาศ มีโครงสร้างร่วมเกิดขึ้น โดยระบุว่าเป็นโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่ผ่านมาว่าโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์สามารถเป็นโครงสร้างอุปเสถียรได้ที่ความดัน บรรยากาศ ไม่ได้เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ตัวอย่างสาร AgInTe₂ แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการเปลี่ยน โครงสร้างครั้งที่หนึ่งและกระบวนการลดความดันสามารถยืนยันได้ว่า ยอดที่ปรากฏเป็นยอดของ โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์จริง เพราะในการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งพบว่าทั้งโครงสร้าง แบบชาลโคไฟไรท์และโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบ *Cmcm* และใน กระบวนการลดความดันพบว่าเมื่อลดความดันกลับสู่ความดันบรรยากาศแล้ว โครง สร้างที่ปรากฏ ขึ้นที่ความดันบรรยากาศมีเพียงโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์เท่านั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าสาร AgInTe₂ ที่นำมาทำการทดลองเป็นสารที่มีความบริสุทธิ์ ทั้งนี้โครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ที่เกิดขึ้น น่าจะเกิดจากกระบวนการปลูกผลึก

4.2 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe₂



4.2.1 โครงสร้างของสาร AgGaTe₂ที่ความดันบรรยากาศ

การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ในสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ แสดงดังภาพที่ 4.16 พบว่าสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ ที่ความดันบรรยากาศมีโครงสร้าง แบบซาลโคไพไรท์ ที่มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.313 Å และ c = 11.994 Å ทั้งนี้มีค่า u = 0.27 และ η =1.98 โดยผลการปรับมีค่า R_{wp} = 2.34 % และค่า R_p = 1.77 %

4.2.2 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งของสาร AgGaTe $_{\!\!2}$

จากภาพที่ 4.15 (บน) พบว่าโพรไฟล์ของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจาย มุม เริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างโดยสังเกตได้จากยอดใหม่ที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (*) เกิดขึ้นที่ความ ดัน 4.37 GPa แต่เมื่อเราพิจารณาภาพที่ 4.15 (ล่าง) พบว่ายอดใหม่เดียวกัน ปรากฏขึ้นที่ความดัน 4.02 GPa ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างที่ความดันประมาณ 4.02 GPa และยอดของโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์หายไปที่ความดันประมาณ 5.09 GPa ซึ่งความดัน

ภาพที่ 4.14 การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ของสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ ที่ความดันบรรยากาศด้วยโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์

ดังกล่าวเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์ไปเป็นโครงสร้าง ใหม่โดยสมบูรณ์



คลื่น 0.44397 Å (ล่าง) โดยที่เครื่องหมาย (*) ระบุยอดใหม่ที่เริ่มปรากฏขึ้น



ภาพที่ 4.16 โพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมของสาร AgGaTe₂ ที่ความดัน 5.09 GPa โดยระบุเครื่องหมายโครงสร้างร่วมที่เกิดขึ้น โดยที่เครื่องหมาย (x) และ (+) ระบุถึงสองโครงสร้างที่ความดันสูง (บน) และทำการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการ ปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์ โดยที่ยอดที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (x) ปรับด้วย โครงสร้างแบบ P4 และยอดที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (+) ปรับด้วยโครงสร้างแบบ *Cmcm* (ล่าง)

จากการพิจารณาโพรไฟล์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุมในภาพที่ 4.16 (บน) ์ ที่ความดัน 5.09 GPa พบว่าโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 2 โครงสร้าง ซึ่งระบุโดยเครื่องหมาย (x) และ (+) ทั้งนี้ในการแยกโครงสร้างร่วมได้พิจารณาจากรูปแบบของยอดที่เกิดการเลี้ยวเบน พบว่ารูปแบบของการเลี้ยวเบนของยอดที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (+) มีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้น ซึ่ง แตกต่างจากยอดที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (x) นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาจากโพรไฟล์การ ้เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างโพรไฟล์ที่เกิดจากความดันในแต่ละค่า ซึ่งได้ แสดงไว้แล้วในภาพที่ 4.15 (ล่าง) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโมริและคณะ (Y. Mori. *et al*) [6] ซึ่งได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe₂ ภายใต้ความดันสูง ซึ่งพบว่า ใครงสร้างที่ความดันสูงเกิดโครงสร้างร่วมขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้จากการปรับโครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัว แปรโครงสร้างของริทเวลด์ ดังแสดงในภาพที่ 4.16 (ล่าง) พบว่าโครงสร้างที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (x) เป็นโครงสร้างแบบเททระโกนอลที่มีหมู่สมมาตรเป็น P $\overline{4}$ มีค่าคงที่แลตทิซเป็น a = 5.833 Å และ c = 5.862 Å โดยมีตำแหน่งคะตคมคล้ายกับโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์ นอกจากนี้โครงสร้าง ร่วมที่ระบุด้วยเครื่องหมาย (+) ซึ่งมียอดที่เด่นชัดค่อนข้างน้อย จึงระบุโครงสร้างได้ค่อนข้างยาก แต่ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวก็สามารถปรับได้ดีกับโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิกที่มีหมู่สมมมาตรเป็น Cmcm ที่มีค่าคงที่แลตทิชเป็น a = 5.512 Å b = 5.738 Å และ c = 6.371 Å มีค่าพารามิเตอร์ ภายในของอะตอม Ag และ Ga เป็น v = 0.63 และของอะตอม Te เป็น v = 0.12 โดยผลการปรับ มีค่า R_{wp} = 4.01 % และค่า R_p = 2.82 % ดังแสดงในภาพที่ 4.16 (ล่าง)

ทั้งนี้มีการเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างร่วม *Cmcm* ไปเป็นโครงสร้างร่วมที่ สองที่ความดันประมาณ 6.99 GPa และเปลี่ยนโครงสร้างสมบูรณ์ที่ความดันประมาณ 7.75 GPa ซึ่งโครงสร้างร่วมที่สองดังกล่าวมียอดเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยเช่นกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุ โครงสร้างได้ชัดเจน



ภาพที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของสาร AgGaTe₂ ที่ได้จากการปรับ โครงสร้างด้วยวิธีการปรับตัวแปรโครงสร้างของริทเวลด์และทำการปรับข้อมูลด้วย สมการสถานะของเบริช-เมอร์นาแกน ลำดับที่สอง

จากภาพที่ 4.17 พบว่าโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร เท่ากับ 41.21 GPa และโครงสร้างแบบ P4 มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตรเท่ากับ 38.43 GPa ทั้งนี้การ เปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบชาลโคไพไรท์เป็นโครงสร้างแบบ P4 และมีปริมาตรลดลง ประมาณ 7 %







จากภาพที่ 4.18 พบว่าโครงสร้างแบบ P4 โครงสร้างร่วมยังคงเสถียร จนกระทั่ง ถึงความดัน 1.93 GPa พบว่าเริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างแบบ P4 และโครงสร้าง ร่วมกลับไปเป็นโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ โดยการเปลี่ยนโครงสร้างกลับสู่โครงสร้างแบบชาลโค ไฟไรท์สมบูรณ์ที่ความดัน 0.90 GPa ที่ความดันบรรยากาศโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์มีค่าคงที่ แลตทิชเป็น a = 6.286 Å และ c = 12.032 Å ทั้งนี้ ทั้งความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างและ ค่าคงที่แลตทิชของโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ในกระบวนการลดความดันมีค่าแตกต่างกับ โครงสร้างในกระบวนการเพิ่มความดัน เช่นเดียวกับกรณีสาร AgInTe₂

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgInTe₂ และ AgGaTe₂ ภายใต้ความดันสูงด้วยเทคนิค การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม จากแหล่งกำเนิดซินโครตรอน โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ รังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นเป็น 0.46540 Å และ 0.44397 Å โดยใช้ไดมอนด์ แอนวิล เซลล์ เป็น อุปกรณ์เพิ่มความดัน การวัดความดันทำได้โดยเทคนิคการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ในทับทิม ซึ่งมีความ ยาวคลื่นจากการเกิดฟลูออเรสเซนซ์สัมพันธ์กับความดัน และใช้อิเมจเพลตเป็นอุปกรณ์สำหรับ บันทึกแถบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งในสาร AgInTe₂ ได้ ทำการคำนวณด้วย DFT เพื่อเปรียบเทียบและสนับสนุนผลการทดลอง ซึ่งสามารถแยกสรุปผลและ วิจารณ์ผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1 สารกึ่งตัวนำ AgInTe₂

การศึกษาสารกิ่งตัวนำ AgInTe₂ ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิด กระจายมุม พบว่าที่ความดันบรรยากาศ AgInTe₂ มีโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ที่มีค่าคงที่ แลตทิซ a = 6.396 Å และ c = 12.515 Å มีค่า u = 0.24 Å และ η = 1.97 ทั้งนี้พบว่ามี โครงสร้างร่วมเป็นโครงสร้างแบบซิงค์เบลนที่มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.262 Å ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของแรงจ์และคณะ [30] เมื่อทำการเพิ่มความดันจนถึง 4.14 GPa พบว่าเกิดการเปลี่ยน โครงสร้างจากโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์ไปเป็นโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิคที่มีหมู่สมมาตรเป็น *Cmcm* มีพารามิเตอร์ภายในของอะตอม Ag และ In เป็น v = 0.75 และของอะตอม Te เป็น v = 0.25 ซึ่งพารามิเตอร์ภายในอังกล่าวทำให้โครงสร้างแบบ *Cmcm* มีตำแหน่งอะตอมคล้ายกับ โครงสร้างแบบคล้าย NaCl ทั้งนี้เนื่องจากผลการทดลองในช่วงการเพิ่มความดันไม่สามารถระบุ ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นที่ ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นที่ ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นที่ ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นที่ ความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างได้ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นที่ ความดันประมาณ 3 – 4 GPa และในการเปลี่ยนโครงสร้างนี้ พบว่าโครงสร้างแบบ *mcm* มีค่ามอดูลัสเซิงปริมาตร เท่ากับ 57.52 GPa ทั้งนี้มีปริมาตรลดลง 14 % และการเปลี่ยนโครงสร้างเกิดขึ้นสมบูรณ์ที่ความ ดันประมาณ 6.25 GPa

ในการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่ง ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยน โครงสร้างโดยการคำนวณด้วย DFT ในสาร AgInTe₂ ด้วยวิธีการคำนวณและการจำลองโครงสร้าง ที่ความดันสูงที่แตกต่างกัน ได้เป็น 2 วิธี ดังนี้

- 1. การคำนวณด้วยวิธีจีโอเมทรีออบทิไมเซชัน
- 2. การคำนวณด้วยวิธีพลังงานจุดเดียว

โดย 2 วิธีดังกล่าวใช้ศักย์เทียมแบบอุลตราซอท์ฟและฟังก์ชัน GGA- PBA โดยผล การคำนวณทั้งสองวิธีได้แสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 การเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่งโดยการคำนวณด้วย DFT ทั้งสองวิธี

วิรีการ	ความดันบรรยากาศ		การเปลี่ยนโครงสร้าง		ความดันสูง	
	โครงสร้าง	B₀(GPa)	ความดัน	ปริมาตรที่ ลดลง	โครงสร้าง	B₀(GPa)
GO	СН	38.04	4.01 GPa	19 %	P4/mmm	51.89
SE	СН	43.26	3.90 GPa	17 %	Стст	52.87

(GO : Geometry Optimization ແລະ SPE : Single Point Energy)

จากตารางที่ 5.1 พบว่าความดันที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่หนึ่ง มีค่าอยู่ ในช่วงความดันประมาณ 3 – 4 GPa ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง ทั้งนี้ ทั้งโครงสร้าง ตำแหน่ง ของอะตอม ค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร และปริมาตรที่ลดลงในการเปลี่ยนโครงสร้าง มีค่าใกล้เคียง และสอดคล้องกับผลการทดลองเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าการคำนวณด้วย DFT ทั้งสองวิธี สามารถ จำลองธรรมชาติของการเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe₂ ภายใต้ความดันสูงได้ โดยเปลี่ยน โครงสร้างจากโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ไปเป็นโครงสร้างที่มีค่า $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$ โดยมี ตำแหน่งอะตอมคล้ายกับโครงสร้างแบบคล้าย NaCl

การเปลี่ยนความดันครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 21.70 GPa ซึ่งการ เปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนหมู่สมมาตร แต่มีการเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายใน ในการ เปลี่ยนโครงสร้างครั้งที่สอง โครงสร้างที่มีหมู่สมมาตรเป็น *Cmcm* มีค่าพารามิเตอร์ของอะตอม Ag และ In เป็น v = 0.674 และของอะตอม Te เป็น v = 0.185 ซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า มีการเลื่อนของ ระนาบ (200) ในทิศทาง [010] ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกับการเปลี่ยนโครงสร้างของสาร CuInSe₂ ภายใต้ความดันสูง

การศึกษาสาร AgInTe₂ ในกระบวนการลดความดัน พบว่าการเปลี่ยนโครงสร้าง กลับสู่โครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์เกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 0.55 GPa และที่ความดัน บรรยากาศโครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.396 Å และ c = 12.441 Å ซึ่งทั้ง ความดันที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างและค่าคงที่แลตทิซมีค่าต่างไปจากกระบวนการเพิ่มความดัน การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe₂ ภายใต้ความดันสูงด้วยเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม ทั้งกระบวนการเพิ่มความดันและกระบวนการลดความดัน ได้แสดงในภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgInTe₂ ในกระบวนการเพิ่มความดัน จากความดัน บรรยากาศถึงความดัน 26 GPa (บน) และในกระบวนการลดความดัน จากความ ดัน 10.25 GPa ถึงความดันบรรยากาศ (ล่าง)

5.1 สารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂

การศึกษาสารกึ่งตัวนำ AgGaTe₂ ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิด กระจายมุม พบว่าที่ความดันบรรยากาศ AgGaTe₂ มีโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์ที่มีค่าคงที่ แลตทิช a = 6.313 Å และ c = 11.994 Å มีค่า u = 0.27 Å และ η = 1.98 โดยการเปลี่ยน โครงสร้างครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 4.02 GPa ซึ่งโครงสร้างที่ความดันสูงเป็น โครงสร้างแบบเททระโกนัลที่มีหมู่สมมาตร P4 และมีตำแหน่งของอะตอมคล้ายกับโครงสร้างแบบ ซิงค์เบลน ในการเปลี่ยนโครงสร้าง พบว่าโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรท์มีค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร เท่ากับ 41.21 GPa และโครงสร้าง พบว่าโครงสร้างดังกล่าวยังพบว่ามีโครงสร้างร่วมเกิดขึ้น ปริมาตรลดลงประมาณ 7 % ทั้งนี้ในการเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวยังพบว่ามีโครงสร้างร่วมเกิดขึ้น ด้วย ซึ่งพิจารณาได้จากรูปแบบของการเลี้ยวเบนที่เกิดขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโมริ และคณะ [6] ซึ่งพบว่าโครงสร้างที่ความดันสูงเกิดโครงสร้างร่วมขึ้นเช่นกัน เนื่องจากโครงสร้าง ดังกล่าวมียอดของการเลี้ยวเบนที่ปรากฏชัดเจนค่อนข้างน้อย จึงทำให้ไม่สามารถระบุโครงสร้าง ร่วมได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ในการศึกษาสาร AgGaTe₂ ในกระบวนการลดความดัน พบว่าการ เปลี่ยนโครงสร้างกลับสู่โครงสร้างแบบซาลโคไฟไรท์เกิดขึ้นที่ความดันประมาณ 1.93 GPa และที่ ความดันบรรยากาศ มีค่าคงที่แลตทิซ a = 6.286 Å และ c = 12.032 Å ซึ่งทั้งความดันที่มีการ เปลี่ยนโครงสร้างและค่าคงที่แลตทิซมีค่าต่างไปจากกระบวนการเพิ่มความดัน ซึ่งเป็นไปในทำนอง เดียวกันกับกรณีของสาร AgInTe₂

การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe₂ ภายใต้ความดันสูงด้วยเทคนิคการ เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม ทั้งกระบวนการเพิ่มความดันและกระบวนการลดความดัน ได้ แสดงในภาพที่ 5.2





5.2 (ล่าง)

ภาพที่ 5.2 การเปลี่ยนโครงสร้างของสาร AgGaTe₂ ในกระบวนการเพิ่มความดัน จากความดัน บรรยากาศถึงความดัน 9.34 GPa (บน) และในกระบวนการลดความดันจากความดัน 9.34 GPa ถึงความดันบรรยากาศ (ล่าง)

รายการอ้างอิง

- [1] W. Paszkowicz. Nuclear Instru. Physical Review B 189(2002) : 142.
- [2] R. Shukla, P. Khurana and K.K. Srivastava. J. Mater. Sci 3(1992) : 132.
- [3] T. Hama, T. Ihara, H. Sato, H. Fujisawa, M. Ohasawa, Y. Ichikawa and H.Sakai. <u>Solar Energy Materials</u> 23(1991) : 380.
- [4] A. K. Arora, T. Sakuntala and L. Artus. <u>Journal of Physics and Chemistry of Solids</u> 54(1993) : 381.
- [5] B. Tell, J.L. Shay, and H.M.Kasper. <u>Physical Review B</u> 9(1974) : 5203.
- [6] Y. Mori and K. Takarabe, <u>Ternary and Multinary Compounds in the 21st Century</u> IPAP Books 1(2001): 175.
- [7] A. Jayaraman, P.D. Dernier, H.M. Kasper and R.G. Maines. <u>High Temperature-High</u> <u>Pressure</u> 9(1977) : 97.
- [8] K.Huang. <u>Statistical Mechanics</u>. 2nd ed. Sinapore : John Wiley&Sons, 1987.
- [9] R. Thangavel, G. Prathiba, B. Anto Naanci, M. Rajagopalan and J. Kumar. <u>Computational Materials Science</u> 40(2007) : 193.
- [10] F. Birch. <u>Physical Review B</u> 71(1947) : 809.
- [11] B.D. Cullity, S.R. Stock. <u>Elements of X-Rays Diffraction</u>. 3rd ed. New Jersey : Prentice, 2001.
- [12] Image Plate. Available from : <u>http://www.fujifilm.com</u>
- [13] V.K. Pecharsky, P.Y. Zavalij, <u>Fundamentals of Powder Diffraction and Structural</u> <u>Characterization of Materials</u>. New York : Springer, 2005.
- [14] Desgreniers S. and K. Lagarec. Journal of Applied Crystallography 31(1998) : 109.
- [15] H. M. Rietveld. Journal Applied Crystallography 2(1969) : 65.
- [16] A. C. Larson and R. B. Von Dreele. <u>Los Alamos National Laboratory Report LAUR</u>, 2000.
- [17] Hung-Chung Hsueh. Ph.D. Thesis. The University of Edinburgh, (1997).
- [18] M.C. Payne, M.P. Teter, D.C. Allan, T.A. Arias and J.D. Joannaopoulos. <u>Reviews of</u> <u>Modern Physics</u> 64(1992) : 1045.
- [19] C.J. Cramer. Essentials of Computational Chemetry. 2nd ed. India : John Wiley&Sons, 2004.

- [20] M. Born and R. Oppenheimer. <u>Annals of Physics</u> 84(1927) :457.
- [21] L. H. Thomas. Proc. Cambridge Philos. Soc. 23(1927) :542.
- [22] E. Fermi. <u>Z. Phys.</u>, 48(1928) :73.
- [23] P. Hohenberg and W. Kohn. <u>Physica Review B.</u> 136(1964) : 864.
- [24] W. Khon and L.J. Sham. <u>Physical Review A.</u> 140(1965) : 1133.
- [25] L. Kleinman and D.M. Bylander. Physical Review Letter 48(1982) :1425.
- [26] Thiti Bovornratanaraks. Ph.D. Thesis. The University of Edinburgh, (2001).
- [27] V. Saengsuwan. M.Sc. Thesis. Chulalongkorn University, (2004).
- [28] L. Merrill and W. A. Bassett.. <u>Review of Scientific Instrument</u> 45(1974) : 290.
- [29] M.I. Eremets. <u>High Pressure Experimental Method</u>. New York : Oxford University Press, 1996.
- [30] K.J. Range, G. Engert, J. Engels, and A. Weiss. <u>Naturforsch. b</u> 24(1968) : 1008.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายคมศิลป์ โคตมูล เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2523 ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2547 เข้าทำงานตำแหน่งครูวิชาการ สาขาวิชา ฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ลาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2549

การนำเสนองาน

- 20-22 เมษายน 2551 K. Kotmool and T. Bovornratanaraks. Phase Transition in AgInTe, under High Pressure. Siam Physics Congress 2008.
- 24-25 กันยายน 2551 K. Kotmool, T. Bovornratanaraks, P. Jimlim, S. Vannarat, and D. Ruffolo. Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe₂ under High Pressure. NECTEC Annual Conference&Exhibitions 2008.